

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-214494

(43) 公開日 平成10年(1998) 8月11日

(51) Int.Cl.^{*}

識別記号

F I

G 1 1 C 16/04

G 1 1 C 17/00

6 2 2 E

H 0 1 L 27/115

H 0 1 L 27/10

4 3 4

21/8247

29/78

3 7 1

29/788

29/792

審査請求 未請求 請求項の数23 O L (全 37 頁)

(21) 出願番号

特願平9-18566

(22) 出願日

平成9年(1997) 1月31日

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 荒瀬 謙士朗

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

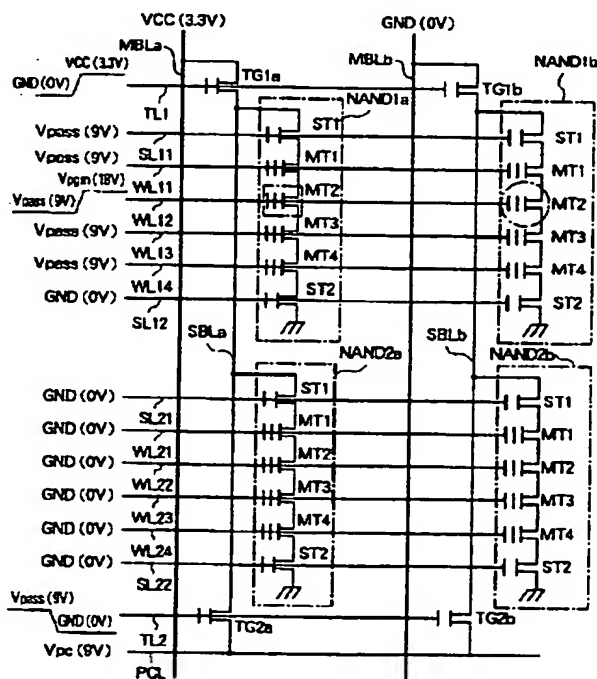
(74) 代理人 弁理士 佐藤 隆久

(54) 【発明の名称】 不揮発性半導体記憶装置

(57) 【要約】

【課題】低電圧での単一電源動作に適し、ビット線毎のデータラッチ回路のレイアウトが容易で、しかもディスタープ耐性の良好なデータプログラム動作を行うNAND型半導体不揮発性記憶装置を実現する。

【解決手段】副ビット線SBL aおよびSBL bを選択して、プリチャージ線PCLから当該副ビット線およびNAND1 a、NAND1 bのチャンネル部電位をプログラム禁止電位(9v)まで上昇させ、プログラムすべきデータ内容に応じて前記NAND列チャンネル部および当該副ビット線に充電されたプログラム禁止電位を主ビット線に放電させ、選択ワード線WL12にプログラム電圧V_{pgm}を印加して当該選択ワード線に接続されたメモリトランジスタ一括にページプログラムを行う。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 主ビット線が作動的接続手段を介して複数の副ビット線に階層化され、前記副ビット線に接続されたメモリトランジスタがマトリクス配置され、これらメモリトランジスタのコントロールゲート電極がワード線に接続されてなる不揮発性半導体記憶装置であって、データプログラム動作時に、副ビット線をプログラム禁止電位に設定する手段と、

プログラム禁止電位に設定された副ビット線のうち、選択された前記副ビットを放電させ、前記副ビット線のうち選択されなかった副ビット線をフローティング状態とする手段と、

選択された前記ワード線にプログラム電圧を印加する手段とを備えた不揮発性半導体記憶装置。

【請求項2】 副ビット線と接地線との間にそれぞれ選択トランジスタを介してメモリトランジスタが複数個直列接続されたNAND列構成を有する請求項1記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項3】 主ビット線が作動的接続手段を介して複数の副ビット線に階層化され、前記副ビット線と接地線との間にそれぞれ選択トランジスタを介して電氣的にデータのプログラムが行われるメモリトランジスタが複数個直列接続されてNAND列を構成し、前記NAND列がマトリクス配置されてなるNAND型の不揮発性半導体記憶装置であって、

データプログラム動作時、選択NAND列が在する副ビット線を選択して当該副ビット線から選択NAND列チャンネル部の電位をプログラム禁止電位まで上昇させる手段と、

プログラムすべきデータ内容に応じて前記NAND列チャンネル部および当該NAND列が接続された副ビット線に充電されたプログラム禁止電位を主ビット線に放電させる手段と、

選択ワード線にプログラム電圧を印加して当該選択ワード線に接続されたメモリトランジスタ一括にページプログラムを行う手段とを備えた不揮発性半導体記憶装置。

【請求項4】 前記主ビット線は、それぞれデータラッチ回路に接続されており、

データプログラム動作時、当該データラッチ回路にページプログラムデータを転送し、ラッチされたデータ内容に応じて選択メモリトランジスタが在するNAND列チャンネル部の電位および当該NAND列が接続された副ビット線に充電されたプログラム禁止電位を主ビット線に放電させる請求項3記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項5】 前記副ビット線は、一方の端部において第1接続トランジスタを介して主ビット線に接続され、他方の端部において第2接続トランジスタを介して当該副ビット線を前記プログラム禁止電位に充電するためのプリチャージ線に接続された請求項3記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項6】 前記第1接続トランジスタおよび第2接続トランジスタは、それぞれゲート電極が第1接続制御線および第2接続制御線に接続されて制御される請求項5記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項7】 前記メモリトランジスタのフローティングゲート電極は第1導電層膜で形成され、

前記メモリトランジスタのコントロールゲート電極が接続されたワード線およびNAND列選択トランジスタの制御電極が接続された選択ゲート線および前記第1接続制御線および第2接続制御線は第2導電層膜で形成され、

前記副ビット線およびプリチャージ線は第3導電層膜で形成され、前記主ビット線は第4導電層膜で形成されている請求項6記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項8】 前記第1導電層膜は第1層目ポリシリコン層であり、

前記第2導電層膜は第2層目ポリシリコン層またはポリサイド層であり、

前記第3導電層膜は第3層目ポリシリコン層またはポリサイド層であり、

前記第4導電層膜はアルミニウム層である請求項8記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項9】 主ビット線が作動的接続手段を介して複数の副ビット線に階層化され、前記副ビット線と接地線との間にそれぞれ選択トランジスタを介して電氣的にデータのプログラムが行われるメモリトランジスタが複数個直列接続されてNAND列を構成し、前記NAND列がマトリクス配置されてなるNAND型の不揮発性半導体記憶装置のデータプログラム方法であって、

選択NAND列が在する副ビット線を選択して当該副ビット線から選択NAND列チャンネル部の電位をプログラム禁止電位まで上昇させる過程と、

プログラムすべきデータ内容に応じて前記NAND列チャンネル部および当該NAND列が接続された副ビット線に充電されたプログラム禁止電位を主ビット線に放電させる過程と、

選択ワード線にプログラム電圧を印加して当該選択ワード線に接続されたメモリトランジスタ一括にページプログラムを行う過程とを有するNAND型不揮発性半導体記憶装置のデータプログラム方法。

【請求項10】 主ビット線が作動的接続手段を介して対となって列方向に配線された第1副ビット線群および第2副ビット線群に階層化され、前記第1副ビット線群を構成する各第1副ビット線および第2副ビット線群を構成する各第2副ビット線と接地線との間にそれぞれ選択トランジスタを介して電氣的にデータのプログラムが行われるメモリトランジスタが複数個直列接続されてそれぞれ第1NAND列および第2NAND列を構成し、前記第1NAND列および第2NAND列がマトリクス配置され、同一行のメモリトランジスタのコントロール

電極が共通のワード線に接続されてなるNAND型の不揮発性半導体記憶装置であって、

データプログラム動作時、選択ワード線と交差する第1副ビット線および第2副ビット線を選択して当該副ビット線から当該選択ワード線と交差する第1NAND列および第2NAND列チャンネル部の電位をともにプログラム禁止電位まで上昇させる手段と、

前記第1NAND列および第2NAND列のうちで非選択側のNAND列チャンネル部および当該NAND列が接続された副ビット線に充電されたプログラム禁止電位をフローティング状態に保持したまま、選択側のNAND列チャンネル部および当該NAND列が接続された副ビット線に充電されたプログラム禁止電位をプログラムすべきデータ内容に応じて主ビット線に放電させる手段と、

選択ワード線にプログラム電圧を印加して前記第1NAND列および第2NAND列のうちで選択側のNAND列のみ選択ワード線に接続されたメモリトランジスタ括にページプログラムを行う手段とを備えた不揮発性半導体記憶装置。

【請求項11】 前記主ビット線は、それぞれデータラッチ回路に接続されており、データプログラム動作時、当該データラッチ回路にページプログラムデータを転送し、ラッチされたデータ内容に応じて前記第1NAND列および第2NAND列のうちで選択側のNAND列チャンネル部の電位および当該NAND列が接続された副ビット線に充電されたプログラム禁止電位を主ビット線に放電させる請求項10記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項12】 前記第1副ビット線および第2副ビット線は、一方の端部においてそれぞれ対応する第1接続トランジスタを介して主ビット線に接続され、他方の端部においてそれぞれ対応する第2接続トランジスタを介して当該副ビット線を前記プログラム禁止電位に充電するためのプリチャージ線に接続された請求項10記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項13】 前記第1副ビット線の第1接続トランジスタおよび第2接続トランジスタは、それぞれゲート電極が第1副ビット線専用の第1接続制御線および第2接続制御線に接続されて制御され、前記第2副ビット線の第1接続トランジスタおよび第2接続トランジスタは、それぞれゲート電極が第2副ビット線専用の第1接続制御線および第2接続制御線に接続されて制御される請求項12記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項14】 前記メモリトランジスタはフローティングゲート電極を有し、前記メモリトランジスタのフローティングゲート電極は第1導電層膜で形成され、前記メモリトランジスタのコントロールゲート電極が接

続されたワード線およびNAND列選択トランジスタの制御電極が接続された選択ゲート線および前記第1接続制御線および第2接続制御線は第2導電層膜で形成され、

前記副ビット線およびプリチャージ線は第3導電層膜で形成され、

前記主ビット線は第4導電層膜で形成されている請求項13記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項15】 前記第1導電層膜は第1層目ポリシリコン層であり、

前記第2導電層膜は第2層目ポリシリコン層またはポリサイド層であり、

前記第3導電層膜は第3層目ポリシリコン層またはポリサイド層であり、

前記第4導電層膜はアルミニウム層である請求項14記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項16】 主ビット線が作動的接続手段を介して対となって列方向に配線された第1副ビット線群および第2副ビット線群に階層化され、前記第1副ビット線群を構成する各第1副ビット線および第2副ビット線群を構成する各第2副ビット線と接地線との間にそれぞれ選択トランジスタを介して電氣的にデータのプログラムが行われるメモリトランジスタが複数個直列接続されてそれぞれ第1NAND列および第2NAND列を構成し、前記第1NAND列および第2NAND列がマトリクス配置され、同一行のメモリトランジスタのコントロール電極が共通のワード線に接続されてなるNAND型の不揮発性半導体記憶装置のデータプログラム方法であって、

データプログラム動作時、選択ワード線と交差する第1副ビット線および第2副ビット線を選択して当該副ビット線から当該選択ワード線と交差する第1NAND列および第2NAND列チャンネル部の電位をともにプログラム禁止電位まで上昇させる過程と、

前記第1NAND列および第2NAND列のうちで非選択側のNAND列チャンネル部および当該NAND列が接続された副ビット線に充電されたプログラム禁止電位をフローティング状態に保持したまま、選択側のNAND列チャンネル部および当該NAND列が接続された副ビット線に充電されたプログラム禁止電位をプログラムすべきデータ内容に応じて主ビット線に放電させる過程と、

選択ワード線にプログラム電圧を印加して前記第1NAND列および第2NAND列のうちで選択側のNAND列のみ選択ワード線に接続されたメモリトランジスタ括にページプログラムを行う過程とを有するNAND型不揮発性半導体記憶装置のデータプログラム方法。

【請求項17】 列状に配線された各主ビット線を複数の列方向に階層化して配線した複数群の副ビット線群と、前記複数群の副ビット線群の任意の一の副ビット線

群から任意の一の副ビット線を選択して前記主ビット線に接続する手段とを備え、
前記副ビット線と接地線との間にそれぞれ選択トランジスタを介して電氣的にデータのプログラムが行われるメモリトランジスタが複数個直列接続されてNAND列を構成し、前記NAND列がマトリクス配置されてなる不揮発性半導体記憶装置。

【請求項18】 前記主ビット線は、それぞれデータラッチ回路に接続されている請求項17記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項19】 前記複数群の副ビット線群は、対となって列方向に階層化して配線された第1副ビット線群および第2副ビット線群である請求項17記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項20】 前記第1副ビット線群を構成する各第1副ビット線は、一方の端部において行方向に配線された第1接続制御線に制御される第1接続トランジスタを介して主ビット線に接続され、
前記第2副ビット線群を構成する各第2副ビット線は、前記第1副ビット線が主ビット線に接続される一方の端部と同一方向の端部で、行方向に配線された第2接続制御線に制御される第2接続トランジスタを介して主ビット線に接続される請求項19記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項21】 前記第1副ビット線群を構成する各第1副ビット線は、一方の端部において行方向に配線された第1接続制御線に制御される第1接続トランジスタを介して主ビット線に接続され、
前記第2副ビット線群を構成する各第2副ビット線は、前記第1副ビット線が主ビット線に接続される一方の端部と逆方向の端部で、行方向に配線された第2接続制御線に制御される第2接続トランジスタを介して主ビット線に接続される請求項19記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項22】 前記メモリトランジスタはフローティングゲート電極を有し、
前記メモリトランジスタのフローティングゲート電極は第1導電層膜で形成され、
前記メモリトランジスタのコントロールゲート電極が接続されたワード線およびNAND列選択トランジスタの制御電極が接続された選択ゲート線および前記第1接続制御線および第2接続制御線は第2導電層膜で形成され、
前記副ビット線は第3導電層膜で形成され、
前記主ビット線は第4導電層膜で形成されている請求項20記載の不揮発性半導体記憶装置。

【請求項23】 前記第1導電層膜は第1層目ポリシリコン層であり、
前記第2導電層膜は第2層目ポリシリコン層またはポリサイド層であり、

前記第3導電層膜は第3層目ポリシリコン層またはポリサイド層であり、

前記第4導電層膜はアルミニウム層である請求項22記載の不揮発性半導体記憶装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、低電圧での単一電源動作に適したNAND型フラッシュメモリ等の不揮発性半導体記憶装置およびそのデータプログラム方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来、EPROM、フラッシュメモリ等の不揮発性半導体記憶装置においては、チャンネルホットエレクトロン注入（以下CHE）によりフローティングゲートに電子を注入してデータのプログラムを行うNOR型の不揮発性半導体記憶装置が主流であった。しかし、上述したNOR型不揮発性半導体記憶装置においては、2個のメモリトランジスタで1個のビットコンタクトおよびソース線を共有するため、高集積化が困難であり、大容量化が図れないという問題がある。

【0003】以上の観点から、複数個のメモリトランジスタを直列接続してNAND列を構成し、2個のNAND列で1個のビットコンタクトおよびソース線を共有することにより、高集積化を実現したNAND型フラッシュメモリが提案されている。

【0004】一般的なNAND型フラッシュメモリにおいて、消去動作は、選択NAND列ブロックの全ワード線に0V、非選択NAND列ブロックの全ワード線およびメモリアレイの基板に高電圧（たとえば20V）を印加する。その結果、選択NAND列ブロックのメモリトランジスタのみ、フローティングゲートから基板に電子が引き抜かれて、メモリトランジスタのしきい値電圧は負方向にシフトして、たとえば-3V程度になる。

【0005】一方、データのプログラム動作は、選択するワード線に接続されたメモリトランジスタ一括に、いわゆるページ単位で行われ、選択するワード線に高電圧（たとえば18V）を、プログラムすべき（1データ）メモリトランジスタが接続されたビット線に0V、プログラムを禁止すべき（0データ）メモリトランジスタが接続されたビット線に中間電圧（たとえば9V）を印加する。その結果、プログラムすべき選択メモリトランジスタのみ、フローティングゲート中に電子が注入されて、選択メモリトランジスタのしきい値電圧は正方向にシフトして、たとえば2V程度になる。

【0006】かかるNAND型フラッシュメモリにおいては、データのプログラムおよび消去ともFN(Fowler Nordheim)トンネル電流により行うため、動作電流をチップ内昇圧回路から供給することが比較的容易であり、単一電源で動作させ易いという利点がある。さらには、ページ単位で、つまり選択するワード線に接続されたメ

モリトランジスタ一括にデータプログラムが行われるため、当然の結果として、プログラム速度の点で優位である。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述したNAND型フラッシュメモリは、以下の不利益を有する。すなわち、NAND型フラッシュメモリのデータプログラム動作は、ページ単位で行われるため、プログラムを禁止すべきメモリトランジスタが接続されたすべてのビット線に対しては中間電圧（たとえば9V）を印加する必要がある。ページ単位でのビット線本数は、通常512バイト、つまりおよそ4000本にもなるため、上記中間電圧を発生する昇圧回路の負荷が大きい。また上記のデータプログラム動作は、プログラムメモリトランジスタのしきい値電圧を制御する必要から、複数回のプログラム／ベリファイ動作を繰り返す行うため、各プログラム毎に、上記プログラム禁止ビット線を中間電圧に充電する必要がある。

【0008】このため、プログラム／ベリファイ回数が多くなると、実質的なプログラム時間より、むしろプログラム／ベリファイ動作におけるビット線電圧の切り替えに要する時間が支配的となり、プログラム速度が律速され、高速プログラムが困難となる。さらには、各ビット線毎に設けられページデータをラッチするためのデータラッチ回路は、中間電圧を扱うため高耐压仕様とする必要があり、必然的にサイズが大きくなり、したがって各ビット線毎のデータラッチ回路のレイアウトが困難となる。

【0009】上述した問題点を解決して、低電圧での単一電源動作に適し、高速プログラムが可能で、しかも各ビット線毎のデータラッチ回路のレイアウトが容易なNAND型フラッシュメモリの新しいプログラム方式が、以下の文献に開示されている。

文献：IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, VOL. 30, NO. 11, NOVEMBER 1995 p1152～p1153における記述、およびFig5～Fig6。

【0010】上述した文献に開示されたデータプログラム動作は、プログラムを禁止すべきメモリトランジスタが接続されたNAND列をフローティング状態として、当該NAND列のチャンネル部電圧を、主として非選択ワード線に印加されるパス電圧（たとえば10V）との容量カップリングにより、自動的に昇圧する。この自動昇圧動作は、セルフブースト動作と呼ばれる。

【0011】図28は、上述したセルフブースト動作によりNAND型フラッシュメモリのデータプログラムを行う場合の動作を説明するための図である。

【0012】図28のNAND型フラッシュメモリは、便宜上、2本のビット線に接続されたNAND列1本に4個のメモリトランジスタが直列接続された場合のメモ

リアレイを示す図であるが、実際のメモリアレイにおいては、1本のNAND列に直列接続されるメモリトランジスタの個数は～16個程度が一般的である。図28において、BLa、BLbはビット線を示し、ビット線BLaには2個の選択トランジスタST1a、ST2a、および4個のメモリトランジスタMT1a～MT4aが直列接続されたNAND列が接続される。また、ビット線BLbには2個の選択トランジスタST1b、ST2b、および4個のメモリトランジスタMT1b～MT4bが直列接続されたNAND列が接続される。選択トランジスタST1aおよびST1bは選択ゲート線SL1により制御され、選択トランジスタST2aおよびST2bは選択ゲート線SL2により制御される。また、メモリトランジスタMT1a～MT4aおよびMT1b～MT4bはそれぞれワード線WL1～WL4により制御される。

【0013】次に、図28のNAND型フラッシュメモリにおいて、ワード線WL2を選択してページプログラムをする場合に、MT2aがプログラムを禁止すべきメモリトランジスタであり、MT2bがプログラムすべきメモリトランジスタである場合の動作について説明する。

【0014】まず、選択ゲート線SL1に電源電圧VCC（3.3V）、選択ゲート線SL2に接地電圧GND（0V）が印加され、プログラムを禁止すべきメモリトランジスタMT2aが接続されたビット線BLaに電源電圧VCC（3.3V）、プログラムすべきメモリトランジスタMT2bが接続されたビット線BLbに接地電圧GND（0V）が印加される。次に、選択ワード線WL2にプログラム電圧V_{pgm}（たとえば18V）が、非選択ワード線WL1、WL3～WL4にパス電圧V_{pass}（たとえば10V）が印加される。

【0015】その結果、プログラムを禁止すべきメモリトランジスタMT2aが接続されたNAND列のチャンネル部はフローティング状態となり、当該チャンネル部の電位は主として非選択ワード線（図28においては3本であるが、一般的には15本である）に印加されるパス電圧V_{pass}とのキャパシタカップリングにより、ブーストされプログラム禁止電圧まで上昇して、メモリトランジスタMT2aへのデータプログラムが禁止される。一方、プログラムすべきメモリトランジスタMT1bが接続されたNAND列のチャンネル部は接地電圧GND（0V）に設定され、選択ワード線に印加されたプログラム電圧V_{pgm}との電位差により、メモリトランジスタMT2bへのデータプログラムがなされ、しきい値電圧は正方向にシフトして、たとえば消去状態の-3Vから2V程度になる。

【0016】図29（a）、（b）は、上述したセルフブースト動作を説明するための図であり、図29（a）はセルフブースト動作時におけるプログラム禁止NAN

D列内の1個のメモリトランジスタを図示したものであり、図29(b)はその等価回路図である。

【0017】図29(a)において、VCはワード線WL(コントロールゲートCG)に印加する電圧、VFはフローティングゲートFGの電位、VchはブーストされたNAND列チャンネル電位、C_{ono}はコントロールゲート/フローティングゲート間の3層絶縁膜で構成される層間容量、C_{tox}はトンネル酸化膜容量、C_{ch}はソース/ドレイン拡散層領域を含むメモリトランジスタのチャンネル部容量である。また、L_{dep}はソース/ドレイン拡散層における空乏層広がり長である。また、図29(b)において、C_{ins}は層間容量C_{ono}とトンネル酸化膜容量C_{tox}の直列

$$Br = C_{ins} / (C_{ins} + C_{ch}) \quad \dots (2)$$

【0021】ところで、プログラム時のセルフブースト動作においては、(1)式のVCはすべてのワード線印加電圧の加重平均となるが、一般的なNAND型フラッシュメモリにおいてはNAND列を構成するワード線本数は16本程度であるため、非選択ワード線に印加するバス電圧が支配的となる。よって、(1)式は(3)式のように表わされる。

【0022】

【数3】

$$V_{ch} = Br * V_{pass} \quad \dots (3)$$

【0023】したがって、 $Br \approx 0.8$ 、 $V_{pass} = 10V$ とすれば、 $V_{ch} \approx 8V$ となり、充分プログラム禁止電圧となりうる。

【0024】上述したセルフブースト動作によるNAND型フラッシュメモリのデータプログラム動作は、非選択ビット線に高電圧の中間電圧を印加する必要がないため、低電圧での単一電源動作に適し、高速プログラムが可能で、しかも各ビット線毎のデータラッチ回路のレイアウトが容易である。

【0025】しかし、上記セルフブースト動作を実現するためには、セルフブースト効率Brを最低限でも0.6~0.8と大きくする必要がある。セルフブースト効率Brが充分にとれない場合は、NAND列チャンネル電位Vchが充分に上昇しないため、図28の例では、非選択メモリトランジスタMT2aに対して誤プログラムが行われる可能性がある。また、バス電圧Vpassを高くすることによりチャンネル電位Vchをもち上げようとすると、図28の例では、非選択メモリトランジスタMT1b、MT3b~MT4bに対して誤プログラムが行われる可能性がある。また、セルフブースト効率Brは原理的に~1にはなりえないため、非選択メモリトランジスタに対して誤プログラムが行われない場合であっても、ディスタブの悪化は免れない。

【0026】NAND型フラッシュメモリのデバイス構造において、上述した問題を回避するためセルフブースト効率Brをできる限り大きく設定するためには、

接続による合成容量である。

【0018】図29(b)の等価回路により、セルフブースト動作時のNAND列チャンネル電位Vchは

(1)式で表わされる。

【0019】

【数1】

$$V_{ch} = Br * VC \quad \dots (1)$$

ここで、Brは下記(2)式で表わされるセルフブースト効率であり、デバイス構造の最適設計により通常~0.8程度に設定する。

【0020】

【数2】

(2)式よりソース/ドレイン拡散層領域を含むメモリトランジスタのチャンネル部容量C_{ch}を小さくする必要があり、そのためにはNAND型メモリアレイが形成されるP型ウェル領域のP型不純物濃度を低く設定しなければならない。

【0027】ところが、上記のようにP型不純物濃度を低く設定すれば、図29(a)に図示される空乏層広がり長L_{dep}が大きくなって、パンチスルー耐性が低下してメモリトランジスタおよび選択トランジスタの短チャンネル化が図れなくなり、ひいては高集積化が実現できなくなる。つまり、従来のNAND型フラッシュメモリのデバイス構造では、セルフブースト効率Brの確保とメモリトランジスタおよび選択トランジスタの短チャンネル化が相反するトレードオフの関係にあるため、ディスタブ耐性の確保と高集積化が相反して両方とも実現することが困難である。

【0028】図30(a)、(b)は上述したトレードオフの関係を示すグラフである。図30(a)において、横軸はメモリアレイPWELL濃度Ndopeを、縦軸はセルフブースト効率Brを示している。また図30(b)においては、横軸はメモリアレイPWELL濃度Ndopeを、縦軸はメモリトランジスタおよび選択トランジスタ(TR)の短チャンネル限界Lminを示している。

【0029】図30(a)により、セルフブースト効率Brを充分に確保するためにはPWELL濃度Ndopeを低く設定する必要があり、図30(b)により、PWELL濃度Ndopeを低く設定するとメモリトランジスタおよび選択トランジスタの短チャンネル化が困難となることが判る。

【0030】ところで、従来のNAND型フラッシュメモリにおいては、列方向に配線された各ビット線毎にアルミニウム配線がされている。この場合、カラム方向のピッチの制約から、各ビット線毎にアルミニウム配線と拡散層とのビットコンタクトおよびデータラッチ回路をレイアウトすることが困難となる。

【0031】上述した問題点を解決して、カラム方向のピッチの制約を緩和して、各ビット線毎のアルミニウム配線と拡散層とのビットコンタクトおよびデータラッチ回路のレイアウトが容易なNAND型フラッシュメモリの構造が、以下の文献に開示されている。

文献：米国特許4962481におけるFig 2のメモリアレイ図およびFig 3のパターンレイアウト図。

【0032】上述した文献に開示されたNAND型フラッシュメモリは、互いに対となって配置されたNAND列2本で1本のビット線をシェアリングすることにより、カラム方向のピッチの制約を緩和している。

【0033】図31は、上述した文献に開示されたNAND型フラッシュメモリのメモリアレイを示す図である。

【0034】図31のNAND型フラッシュメモリは、便宜上、1本のビット線に互いに対となって配置された2本のNAND列が接続され、各NAND列に4個のメモリトランジスタが直列接続された場合のメモリアレイを示す図であるが、実際のメモリアレイにおいては、1本のNAND列に直列接続されるメモリトランジスタの個数は～16個程度が一般的である。図31において、BLはビット線を示し、当該ビット線には互いに対となる2本のNAND列NANDaおよびNANDbが接続されている。NAND列NANDaは、2個の選択トランジスタST1a、ST2a、および4個のメモリトランジスタMT1a～MT4a、およびパストランジスタPass-TRが直列接続されて構成される。NAND列NANDbは、2個の選択トランジスタST1b～ST2b、および4個のメモリトランジスタMT1b～MT4b、およびパストランジスタPass-TRが直列接続されて構成される。

【0035】選択トランジスタST1aおよびST1bはそれぞれ選択ゲート線SL1aおよびSL1bにより制御され、選択トランジスタST2aおよびST2bは選択ゲート線SL2により制御され、またメモリトランジスタMT1a～MT4aおよびMT1b～MT4bはそれぞれワード線WL1～WL4により制御される。ここで、NAND列NANDaのパストランジスタPass-TRは選択ゲート線SL1bにより制御され、NAND列NANDbのパストランジスタPass-TRは選択ゲート線SL1aにより制御されるが、これらのパストランジスタPass-TRはチャンネル部にリン

(P)等のN型不純物層が形成されており、選択ゲート線に印加する電圧にかかわらず常にオン状態となる。したがって、図31のメモリアレイにおいては、選択ゲート線SL1aがハイレベルであり、選択ゲート線SL1bがローレベルである場合には、NAND列NANDaがビット線BLに接続される。選択ゲート線SL1bがハイレベルであり、選択ゲート線SL1aがローレベルである場合にはNAND列NANDbがビット線BLに

接続される。

【0036】図32は図31のNAND型フラッシュメモリのパターンレイアウト図である。また、図33

(a)、(b)は図32のパターンレイアウト図におけるデバイス構造断面図であり、図33(a)はA-A'方向からの、図33(b)はB-B'方向からの断面図を示している。

【0037】図32および図33(a)、(b)において、100は半導体基板、101はメモリアレイ領域が形成されるP型ウェル領域、102はメモリトランジスタのソースおよびドレインN型拡散層、103はVSS配線およびビットコンタクト部のN型拡散層、103aはパストランジスタのチャンネル部に形成されたN型拡散層、104はトンネル酸化膜、105は選択トランジスタ部のゲート酸化膜、105aはLOCOS素子分離酸化膜、106はフローティングゲート電極をなす第1層目ポリシリコンゲート電極、107はONO-3層絶縁膜、108はメモリトランジスタおよび選択トランジスタの制御ゲート電極をなす第2層目ポリシリコン配線、112aはアルミニウム配線下の層間絶縁膜、113aはアルミニウム配線下のコンタクトホール、114はアルミニウム配線をそれぞれ示している。

【0038】上述したNAND型フラッシュメモリのメモリアレイにおいては、ビット線レイアウトのカラム方向のピッチは通常の倍に緩和されるため、各ビット線毎のアルミニウム配線と拡散層とのビットコンタクトおよびデータラッチ回路のレイアウトが容易である。

【0039】しかし、上記したメモリアレイは、各NAND列毎に1個のパストランジスタを余分に直列接続する必要があるため、実質的にメモリセルサイズが6～7%程度大きくなり、コスト高になるという不利益がある。

【0040】本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、その第1番目の目的は、低電圧での単一電源動作に適し、ビット線毎のデータラッチ回路のレイアウトが容易で、しかもディスターブ耐性の良好なデータプログラム動作を行う不揮発性半導体記憶装置を提供することにある。また、本発明の第2番目の目的は、実質的にメモリセルサイズを大きくすることなく、ビット線レイアウトのカラム方向のピッチを緩和できる不揮発性半導体記憶装置を提供することにある。

【0041】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明は、主ビット線が作動的接続手段を介して複数の副ビット線に階層化され、前記副ビット線に接続されたメモリトランジスタがマトリクス配置され、これらメモリトランジスタのコントロールゲート電極がワード線に接続されてなる不揮発性半導体記憶装置であって、データプログラム動作時に、副ビット線をプログラム禁止電位に設定する手段と、プログラム禁止電位に設定さ

れた副ビット線のうち、選択された前記副ビットを放電させ、前記副ビット線のうち選択されなかった副ビット線をフローティング状態とする手段と、選択された前記ワード線にプログラム電圧を印加する手段とを備えている。

【0042】また、本発明は、主ビット線が作動的接続手段を介して複数の副ビット線に階層化され、前記副ビット線と接地線との間にそれぞれ選択トランジスタを介して電気的にデータのプログラムが行われるメモリトランジスタが複数個直列接続されてNAND列を構成し、前記NAND列がマトリクス配置されてなるNAND型の不揮発性半導体記憶装置であって、データプログラム動作時、選択NAND列が在する副ビット線を選択して当該副ビット線から選択NAND列チャンネル部の電位をプログラム禁止電位まで上昇させる手段と、プログラムすべきデータ内容に応じて前記NAND列チャンネル部および当該NAND列が接続された副ビット線に充電されたプログラム禁止電位を主ビット線に放電させる手段と、選択ワード線にプログラム電圧を印加して当該選択ワード線に接続されたメモリトランジスタ一括にページプログラムを行う手段とを備えている。

【0043】また、本発明は、主ビット線が作動的接続手段を介して対となって列方向に配線された第1副ビット線群および第2副ビット線群に階層化され、前記第1副ビット線群を構成する各第1副ビット線および第2副ビット線群を構成する各第2副ビット線と接地線との間にそれぞれ選択トランジスタを介して電気的にデータのプログラムが行われるメモリトランジスタが複数個直列接続されてそれぞれ第1NAND列および第2NAND列を構成し、前記第1NAND列および第2NAND列がマトリクス配置され、同一行のメモリトランジスタのコントロール電極が共通のワード線に接続されてなるNAND型の不揮発性半導体記憶装置であって、データプログラム動作時、選択ワード線と交差する第1副ビット線および第2副ビット線を選択して当該副ビット線から当該選択ワード線と交差する第1NAND列および第2NAND列チャンネル部の電位をともにプログラム禁止電位まで上昇させる手段と、前記第1NAND列および第2NAND列のうちで非選択側のNAND列チャンネル部および当該NAND列が接続された副ビット線に充電されたプログラム禁止電位をフローティング状態に保持したまま、選択側のNAND列チャンネル部および当該NAND列が接続された副ビット線に充電されたプログラム禁止電位をプログラムすべきデータ内容に応じて主ビット線に放電させる手段と、選択ワード線にプログラム電圧を印加して前記第1NAND列および第2NAND列のうちで選択側のNAND列のみ選択ワード線に接続されたメモリトランジスタ一括にページプログラムを行う手段とを備えている。

【0044】また、本発明の不揮発性半導体記憶装置

は、列状に配線された各主ビット線を複数の列方向に階層化して配線した複数群の副ビット線群と、前記複数群の副ビット線群の任意の1の副ビット線群から任意の1の副ビット線を選択して前記主ビット線に接続する手段と、を備え、前記副ビット線と接地線との間にそれぞれ選択トランジスタを介して電気的にデータのプログラムが行われるメモリトランジスタが複数個直列接続されてNAND列を構成し、前記NAND列がマトリクス配置されている。

【0045】また、前記複数群の副ビット線群は、対となって列方向に階層化して配線された第1副ビット線群および第2副ビット線群である。

【0046】本発明の不揮発性半導体記憶装置、たとえばNAND型の不揮発性半導体記憶装置によれば、主ビット線が副ビット線に階層化されたメモリアレイ構成をなし、メモリトランジスタがプログラムを禁止すべきメモリトランジスタである場合、当該NAND列チャンネル部の電位を副ビット線を介してプログラム禁止電位まで充電する。したがって、従来の主ビット線を介して非選択NAND列チャンネル部の電位をプログラム禁止電位まで充電する方式に比較して、充電容量を大幅に減少させることにより低電圧動作に適し、さらにデータラッチ回路のレイアウトも容易となる。また、ワード線印加電圧の容量カップリングによりNAND列チャンネル部の電位を上昇させるセルフブースト動作と比較して、プログラム禁止電位を充分高い電圧値に設定することが可能である。そのために、データプログラム時のディスタブ耐性を向上させることができる。

【0047】また、本発明のNAND型不揮発性半導体記憶装置によれば、主ビット線が対となって列方向に配線された第1副ビット線群および第2副ビット線群に階層化されたメモリアレイ構成をなし、非選択側の副ビット線から充電したNAND列チャンネル部のプログラム禁止電位を保持したまま、選択側の副ビット線から充電したNAND列に対して選択的にページプログラムを行う。したがって、従来の主ビット線を介して非選択NAND列チャンネル部の電位をプログラム禁止電位まで充電する方式に比較して、充電容量を大幅に減少させることにより低電圧動作に適するだけでなく、さらに主ビット線のカラム方向のピッチを緩和できるため、アルミニウム配線と拡散層とのビットコンタクトおよびデータラッチ回路のレイアウトも容易となる。また、ワード線印加電圧の容量カップリングによりNAND列チャンネル部の電位を上昇させるセルフブースト動作と比較して、プログラム禁止電位を充分高い電圧値に設定することが可能である。そのために、データプログラム時のディスタブ耐性を向上させることができる。

【0048】また、本発明のNAND型不揮発性半導体記憶装置によれば、主ビット線が複数の列方向に複数群の副ビット線群に階層化されたメモリアレイ構成をなし

ている。したがって、主ビット線のカラム方向のピッチを緩和できるため、アルミニウム配線と拡散層とのビットコンタクトおよびデータラッチ回路のレイアウトが容易となる。

【0049】

【発明の実施の形態】

第1実施例

図1は本発明に係る第1実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置の構成例を示す図である。

【0050】図1のNAND型不揮発性半導体記憶装置は、メモリアレイ10、ローデコーダ20、データラッチ回路群30、カラム選択部40、および昇圧回路50により構成されている。

【0051】図1のNAND型不揮発性半導体記憶装置は、便宜上、2本の主ビット線、各主ビット線毎に階層化された2本の副ビット線、各副ビット線毎に接続された2本のNAND列からなるメモリアレイを有するものであるが、実際のメモリアレイにおいては、たとえば64Mビットのメモリの場合、主ビット線は512バイト（約4k本）、各主ビット線毎に階層化された副ビット線は16本、各副ビット線毎に接続されたNAND列は64本、各NAND列に直列接続されるメモリトランジスタの個数は16個程度である。

【0052】メモリアレイ10において、MBL a、MBL bは主ビット線を示し、主ビット線MBL aは副ビット線SBL aおよびSBL a'に階層化され、主ビット線MBL bは副ビット線SBL bおよびSBL b'に階層化されている。副ビット線SBL aは接続トランジスタTG1 aを介して主ビット線MBL aに接続され、接続トランジスタTG2 aを介してプリチャージ線PCLに接続される。副ビット線SBL a'は接続トランジスタTG1 a'を介して主ビット線MBL aに接続され、接続トランジスタTG2 a'を介してプリチャージ線PCLに接続される。副ビット線SBL bは接続トランジスタTG1 bを介して主ビット線MBL bに接続され、接続トランジスタTG2 bを介してプリチャージ線PCLに接続される。副ビット線SBL b'は接続トランジスタTG1 b'を介して主ビット線MBL bに接続され、接続トランジスタTG2 b'を介してプリチャージ線PCLに接続される。

【0053】接続トランジスタTG1 a、TG1 bは接続制御線TL1により制御され、接続トランジスタTG1 a'、TG1 b'は接続制御線TL1'により制御され、接続トランジスタTG2 a、TG2 bは接続制御線TL2により制御され、接続トランジスタTG2 a'、TG2 b'は接続制御線TL2'により制御される。

【0054】副ビット線SBL aはNAND列NAND1 aおよびNAND2 aに接続され、副ビット線SBL a'はNAND列NAND1 a'およびNAND2 a'に接続され、副ビット線SBL bはNAND列NAND

1 bおよびNAND2 bに接続され、副ビット線SBL b'はNAND列NAND1 b'およびNAND2 b'に接続される。各NAND列は選択トランジスタおよびメモリトランジスタが直列接続されてなり、それぞれ選択ゲート線SL (SL') およびワード線WL (WL') により制御される。主ビット線MBL aはデータラッチ回路SA aに接続され、主ビット線MBL bはデータラッチ回路SA bに接続されている。

【0055】昇圧回路50は、データプログラム動作時に高電圧VPPおよび中間電圧VMを発生し、ローデコーダ20にプログラム電圧Vpgm (VPP) およびパス電圧Vpass (VM) を供給し、プリチャージ線PCLにプログラム禁止のプリチャージ電圧Vpc (VM) を供給する。

【0056】図2は、図1のNAND型不揮発性半導体記憶装置において、メモリアレイ10の具体的構成を示す図であるが、便宜上、2本の主ビット線と、各主ビット線毎に1本の副ビット線のみが図示されている。

【0057】図2において、主ビット線MBL aは副ビット線SBL aに階層化され、主ビット線MBL bは副ビット線SBL bに階層化されている。副ビット線SBL aは接続トランジスタTG1 aを介して主ビット線MBL aに接続され、接続トランジスタTG2 aを介してプリチャージ線PCLに接続される。副ビット線SBL bは接続トランジスタTG1 bを介して主ビット線MBL bに接続され、接続トランジスタTG2 bを介してプリチャージ線PCLに接続される。接続トランジスタTG1 a、TG1 bは接続制御線TL1により制御され、接続トランジスタTG2 a、TG2 bは接続制御線TL2により制御される。副ビット線SBL aにはNAND列NAND1 aおよびNAND2 aが接続され、副ビット線SBL bにはNAND列NAND1 bおよびNAND2 bが接続されている。

【0058】各NAND列はそれぞれ2個の選択トランジスタST1、ST2、および4個のメモリトランジスタMT1~MT4が直列接続されて構成されている。NAND列NAND1 aおよびNAND1 bにおいて、選択トランジスタST1は選択ゲート線SL11により制御され、選択トランジスタST2は選択ゲート線SL12により制御され、またメモリトランジスタMT1~MT4はそれぞれワード線WL11~WL14により制御される。NAND列NAND2 aおよびNAND2 bにおいて、選択トランジスタST1は選択ゲート線SL21により制御され、選択トランジスタST2は選択ゲート線SL22により制御され、またメモリトランジスタMT1~MT4はそれぞれワード線WL21~WL24により制御される。なお、図2の構成においては、便宜上、NAND列1本に4個のメモリトランジスタが直列接続されているが、実際の構成においては、1本のNAND列に直列接続されるメモリトランジスタの

個数は～16個程度である。

【0059】図3は図2のNAND型不揮発性半導体記憶装置のパターンレイアウト図である。また、図4は図3のパターンレイアウト図におけるA-A'方向からの、デバイス構造断面図を示している。

【0060】図3および図4において、100は半導体基板、101はメモリアレイ領域が形成されるP型ウェル領域、102はメモリトランジスタのソースおよびドレインN型拡散層、103はVSS配線およびビットコンタクト部のN型拡散層、104はトンネル酸化膜、105は選択トランジスタ部のゲート酸化膜、106はフローティングゲート電極をなす第1層目ポリシリコンゲート電極、107はONO-3層絶縁膜、108はメモリトランジスタおよび選択トランジスタの制御ゲート電極をなす第2層目ポリシリコン配線、109は第3層目ポリシリコン配線下の層間絶縁膜、110は第3層目ポリシリコン配線下のコンタクトホール、111は副ビット線およびプリチャージ線をなす3層目ポリシリコン配線、112はアルミニウム配線下の層間絶縁膜、113はアルミニウム配線下のコンタクトホール、および114は主ビット線をなすアルミニウム配線をそれぞれ示している。

【0061】次に、図1および図2のNAND型不揮発性半導体記憶装置におけるデータプログラム動作について図5に関連付けて説明する。図5は、ワード線WL12を選択してページプログラムをする場合に、NAND列NAND1a内のMT2がプログラムを禁止すべきメモリトランジスタであり、NAND列NAND1b内のMT2がプログラムすべきメモリトランジスタである場合の動作を説明するための図である。

【0062】まず、接続制御線TL1に接地電圧GND(0V)が印加され副ビット線SBLaおよびSBLbが主ビット線MBLaおよびMBLbから切り離された状態で、接続制御線TL2にパス電圧Vpass(9V)が印加される。これにより、副ビット線SBLaおよびSBLbがプリチャージ線PCLからプログラム禁止のプリチャージ電圧(9V)に充電される。同時に、選択ゲート線SL12に接地電圧GND(0V)が印加され、選択ゲート線SL11およびワード線WL11～WL14にパス電圧Vpass(9V)が印加される。これにより、NAND列NAND1aおよびNAND1bのチャンネル部が副ビット線SBLaおよびSBLbを介してプログラム禁止電圧(9V)まで充電される。このとき、非選択のNAND列NAND2aおよびNAND2bにおいては、選択ゲート線SL21、SL22およびワード線WL21～WL24に接地電圧GND(0V)が印加されているので、当該NAND列は副ビット線と切り離され、メモリトランジスタには電圧が印加されていない状態である。

【0063】次に、接続制御線TL2が接地電圧GND

(0V)に立ち下げられて副ビット線SBLaおよびSBLbがプリチャージ線PCLから切り離された状態で、接続制御線TL1が電源電圧VCC(3.3V)に立ち上げられて副ビット線SBLaおよびSBLbが主ビット線MBLaおよびMBLbに接続される。ここで、プログラムを禁止すべきメモリトランジスタ(NAND1a内のMT2)が接続された主ビット線MBLaは電源電圧VCC(3.3V)に、プログラムすべきメモリトランジスタ(NAND1b内のMT2)が接続された主ビット線MBLbは接地電圧GND(0V)に、それぞれ対応するデータラッチ回路を介して設定されている。その結果、NAND列NAND1aのチャンネル部および副ビット線SBLaはフローティング状態のままプログラム禁止電位に保持されるが、NAND列NAND1bのチャンネル部および副ビット線SBLbのプログラム禁止電位は主ビット線MBLbに放電される。同時に、選択ワード線WL12の印加電圧がプログラム電圧Vpgm(18V)に立ち上げられる。その結果、NAND列NAND1a内のメモリトランジスタMT2はプログラム禁止電圧により消去状態に保持され、NAND列NAND1b内のメモリトランジスタMT2はプログラム電圧Vpgmによりデータプログラムがなされ、しきい値電圧は正方向にシフトして、たとえば消去状態の-3Vから2V程度になる。

【0064】上述した図5の実施例は、従来の主ビット線を介して非選択NAND列チャンネル部の電位をプログラム禁止電位まで充電する方式に比較して、充電容量を大幅に減少させることができることから、低電圧動作に適しており、さらにデータラッチ回路のレイアウトも容易である。また、ワード線印加電圧の容量カップリングによりNAND列チャンネル部の電位を上昇させる従来のセルフブースト動作と比較して、プログラム禁止電位を充分高い電圧値(～9V)に設定することが可能である。したがって、非選択メモリトランジスタに対するディスタブ耐性を向上させることができる。

【0065】図6は、上述した図5に関連付けて説明した動作のタイミングチャートを示す図である。以下、図5のデータプログラム動作を、図6のタイミングチャートを参照しながらさらに詳細に説明する。

【0066】まず図6において、(a)に示すφP/Rはプログラム/ベリファイ制御信号であり、図中時刻t1～t4の間は第1回目のプログラム/ベリファイ動作が行われ、また時刻t4～t7の間は第2回目のプログラム/ベリファイ動作が行われる。

【0067】まず、時刻t1で第1回目のプログラム動作が開始されて、図6(b)、(d)に示すように、接続制御線TL1および選択ゲート線SL12に接地電圧GND(0V)が印加され、図6(c)、(e)および(f)に示すように、接続制御線TL2および選択ゲート線SL11およびすべてのワード線WLにパス電圧V

pass (9V) が印加される。その結果、図6 (g), (h) に示すように、NAND列NAND1aのチャンネル部電位VCHaおよびNAND列NAND1bのチャンネル部電位VCHbは、副ビット線およびプリチャージ線を介してプログラム禁止電圧Vpc (9V) まで充電される。

【0068】次に、図6 (c), (b) に示すように、時刻t2で、接続制御線TL2が接地電圧GND (0V) に立ち下げられ、接続制御線TL1が電源電圧VCC (3.3V) に立ち上げられる。その結果、図6

(g), (h) に示すように、プログラムを禁止すべきメモリトランジスタが在するチャンネル部電位VCHaはフローティング状態のままプログラム禁止電位を保持するが、プログラムすべきメモリトランジスタが在するVCHbのプログラム禁止電位は主ビット線に放電されてGND (0V) になる。一方、図6 (e) に示すように、選択ワード線にはプログラム電圧Vpgm (18V) が印加され、時刻t2~t3の間において、当該ワード線に接続されたメモリトランジスタ一括にページプログラムが行われる。

【0069】次に時刻t3~t4の間は、第1回目のベリファイ動作期間であり、図6 (c), (e) に示すように、接続制御線TL2および選択ワード線にそれぞれ電源電圧VCCおよび接地電圧GNDが印加され、図6 (b), (f), (d) に示すように、接続制御線TL1およびすべての非選択ワード線および選択ゲート線SL11およびSL12に電源電圧VCCが印加されてパス状態として、通常のNAND型フラッシュメモリと同様のベリファイ動作が行われる。また、時刻t4~t7の間は第2回目のプログラム/ベリファイ動作であり、第1回目のプログラム/ベリファイ動作のまったくの繰り返しである。

【0070】図7は、図1~図6の本発明の第1実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置において、すでに説明したプログラム動作、および消去動作、読み出し動作についての、各バイアス設定を示す図である。なお図中、プログラム動作は便宜上プリチャージ時 (図6において時刻t1~t2) と実プログラム時 (図6において時刻t2~t3) に分けて示されている。

【0071】図7において、プログラム動作はすでに説明したとおりであり、再度の説明を省略する。消去動作については、従来のNAND型フラッシュメモリと基本的に同様であり、選択NAND列ブロックの全ワード線に0V、非選択NAND列ブロックの全ワード線およびメモリアレイの基板PWEELLに高電圧 (Verase = 22V) が印加される。その結果、選択NAND列ブロックのメモリトランジスタのみ、フローティングゲートから基板に電子が引き抜かれて、メモリトランジスタのしきい値電圧は負方向にシフトして、たとえば-3V程度になる。読み出し動作についても、従来のNAND

型フラッシュメモリと基本的に同様であり、選択NAND列ブロックにおいては、選択ワード線に接地電圧GNDが印加され、すべての非選択ワード線および選択ゲート線SLおよび接続制御線TL1に電源電圧VCCが印加されてパス状態として、通常のNAND型フラッシュメモリと同様の読み出し動作が行われる。

【0072】以上説明したように、本第1実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置によれば、主ビット線が副ビット線に階層化されたメモリアレイ構成をなし、メモリトランジスタがプログラムを禁止すべきメモリトランジスタである場合、当該NAND列チャンネル部の電位を副ビット線を介してプログラム禁止電位まで充電する。したがって、従来の主ビット線を介して非選択NAND列チャンネル部の電位をプログラム禁止電位まで充電する方式に比較して、充電容量を大幅に減少させることができることから低電圧動作に適し、さらにデータラッチ回路のレイアウトも容易となる。また、ワード線印加電圧の容量カップリングによりNAND列チャンネル部の電位を上昇させるセルフブースト動作と比較して、プログラム禁止電位を充分高い電圧値に設定することが可能である。そのために、データプログラム時のディスタープ耐性を向上させることができる。

【0073】第2実施例

図8は本発明に係る第2実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置の構成例を示す図である。本第2実施例が上記第1実施例と異なる点は、プリチャージ線を用いることなく、主ビット線から選択トランジスタを介してプログラム禁止電圧 (9V) を副ビット線に供給した後、選択トランジスタのゲート電位を電源電圧VCCレベルに保持した状態で、選択された主ビット線は接地電圧GNDに設定し、非選択の主ビット線は電源電圧VCCに設定して、選択されなかった副ビット線をフローティング状態とするようにしたことにある。

【0074】図8のNAND型不揮発性半導体記憶装置は、メモリアレイ10A、ローデコーダ20、データラッチ回路群30、カラム選択部40、および昇圧回路50により構成されている。

【0075】図8のNAND型不揮発性半導体記憶装置は、便宜上、2本の主ビット線、各主ビット線毎に階層化された2本の副ビット線、各副ビット線毎に接続された2本のNAND列からなるメモリアレイを示す図であるが、実際のメモリアレイにおいては、たとえば64Mビットのメモリの場合、主ビット線は512バイト (約4k本)、各主ビット線毎に階層化された副ビット線は16本、各NAND列に直列接続されるメモリトランジスタの個数は16個程度である。

【0076】メモリアレイ10Aにおいて、MBLa、MBLbは主ビット線を示し、主ビット線MBLaは副ビット線SBLaおよびSBLa' に階層化され、主ビット線MBLbは副ビット線SBLbおよびSBLb'

に階層化されている。副ビット線SBL aの一端側は接続トランジスタTG1 aを介して主ビット線MBL aに接続され、副ビット線SBL a'は接続トランジスタTG1 a'を介して主ビット線MBL aに接続される。副ビット線SBL bは接続トランジスタTG1 bを介して主ビット線MBL bに接続され、副ビット線SBL b'は接続トランジスタTG1 b'を介して主ビット線MBL bに接続される。

【0077】接続トランジスタTG1 a、TG1 bは接続制御線TL1により制御され、接続トランジスタTG1 a'、TG1 b'は接続制御線TL1'により制御される。

【0078】副ビット線SBL aはNAND列NAND1 aおよびNAND2 aに接続され、副ビット線SBL a'はNAND列NAND1 a'およびNAND2 a'に接続され、副ビット線SBL bはNAND列NAND1 bおよびNAND2 bに接続され、副ビット線SBL b'はNAND列NAND1 b'およびNAND2 b'に接続される。各NAND列は選択トランジスタおよびメモリトランジスタが直列接続されてなり、それぞれ選択ゲート線SL (SL') およびワード線WL (WL') により制御される。主ビット線MBL aはデータラッチ回路SA aに接続され、主ビット線MBL bはデータラッチ回路SA bに接続されている。

【0079】昇圧回路50は、データプログラム動作時に高電圧VPPおよび中間電圧VMを発生し、ローデコード20にプログラム電圧Vp gm (VPP) およびバス電圧Vpass (VM) を供給する。

【0080】図9は、図8のNAND型不揮発性半導体記憶装置において、メモリアレイ10Aの具体的構成を示す図であるが、便宜上、2本の主ビット線と、各主ビット線毎に1本の副ビット線のみが図示されている。

【0081】図9において、主ビット線MBL aは副ビット線SBL aに階層化され、主ビット線MBL bは副ビット線SBL bに階層化されている。副ビット線SBL aは接続トランジスタTG1 aを介して主ビット線MBL aに接続され、副ビット線SBL bは接続トランジスタTG1 bを介して主ビット線MBL bに接続される。接続トランジスタTG1 a、TG1 bは接続制御線TL1により制御される。副ビット線SBL aにはNAND列NAND1 aおよびNAND2 aが接続され、副ビット線SBL bにはNAND列NAND1 bおよびNAND2 bが接続されている。

【0082】各NAND列はそれぞれ2個の選択トランジスタST1、ST2、および4個のメモリトランジスタMT1~MT4が直列接続されて構成されている。NAND列NAND1 aおよびNAND1 bにおいて、選択トランジスタST1は選択ゲート線SL11により制御され、選択トランジスタST2は選択ゲート線SL12により制御され、またメモリトランジスタMT1

~MT4はそれぞれワード線WL11~WL14により制御される。NAND列NAND2 aおよびNAND2 bにおいて、選択トランジスタST1は選択ゲート線SL21により制御され、選択トランジスタST2は選択ゲート線SL22により制御され、またメモリトランジスタMT1~MT4はそれぞれワード線WL21~WL24により制御される。なお、図2の構成においては、便宜上、NAND列1本に4個のメモリトランジスタが直列接続されているが、実際の構成においては、1本のNAND列に直列接続されるメモリトランジスタの個数は~16個程度である。

【0083】図10は図9のNAND型不揮発性半導体記憶装置のパターンレイアウト図である。また、図11は図10のパターンレイアウト図におけるA-A'方向からの、デバイス構造断面図を示している。

【0084】図10および図11において、100は半導体基板、101はメモリアレイ領域が形成されるP型ウェル領域、102はメモリトランジスタのソースおよびドレインN型拡散層、103はVSS配線およびビットコンタクト部のN型拡散層、104はトンネル酸化膜、105は選択トランジスタ部のゲート酸化膜、106はフローティングゲート電極をなす第1層目ポリシリコンゲート電極、107はONO-3層絶縁膜、108はメモリトランジスタおよび選択トランジスタの制御ゲート電極をなす第2層目ポリシリコン配線、109は第3層目ポリシリコン配線下の層間絶縁膜、110は第3層目ポリシリコン配線下のコンタクトホール、111は副ビット線およびブリッジ線をなす3層目ポリシリコン配線、112はアルミニウム配線下の層間絶縁膜、113はアルミニウム配線下のコンタクトホール、および114は主ビット線をなすアルミニウム配線をそれぞれ示している。

【0085】次に、図8および図9のNAND型不揮発性半導体記憶装置におけるデータプログラム動作について図12に関連付けて説明する。図12は、ワード線WL12を選択してページプログラムをする場合に、NAND列NAND1 a内のMT2がプログラムを禁止すべきメモリトランジスタであり、NAND列NAND1 b内のMT2がプログラムすべきメモリトランジスタである場合の動作を説明するための図である。

【0086】まず、接続制御線TL1に接地電圧GND (0V) が印加され副ビット線SBL aおよびSBL bが主ビット線MBL aおよびMBL bから切り離された状態で、主ビット線MBL a、MBL bにバス電圧Vpass (9V) が印加される。この状態で接続制御線TL1にバス電圧Vpassが印加され、接続トランジスタTG1 a、TG1 bが導通状態に制御される。これにより、副ビット線SBL aおよびSBL bがプログラム禁止のバス電圧Vpass (9V) に充電される。同時に、選択ゲート線SL12に接地電圧GND (0V) が

印加され、選択ゲート線SL11およびワード線WL11~WL14にバス電圧Vpass(9V)が印加される。これにより、NAND列NAND1aおよびNAND1bのチャンネル部が副ビット線SBLaおよびSBLbを介してプログラム禁止電圧(9V)まで充電される。このとき、非選択のNAND列NAND2aおよびNAND2bにおいては、選択ゲート線SL21、SL22およびワード線WL21~WL24に接地電圧GND(0V)が印加されているので、当該NAND列は副ビット線と切り離され、メモリトランジスタには電圧が印加されていない状態である。

【0087】次に、接続制御線TL1が電源電圧VCC(3.3V)に立ち下げられ、この状態で選択された側の主ビット線MBLbが接地電圧GND(0V)に立ち下げられ、選択されない側の主ビット線MBLaが電源電圧VCC(3.3V)に立ち下げられる。これにより、接続トランジスタTG1bは接続状態に保持され、接続トランジスタTG1aはカットオフ状態となる。その結果、NAND列NAND1aのチャンネル部および副ビット線SBLaはフローティング状態のままプログラム禁止電位に保持されるが、NAND列NAND1bのチャンネル部および副ビット線SBLbのプログラム禁止電位は主ビット線MBLbに放電される。同時に、選択ワード線WL12の印加電圧がプログラム電圧Vpgm(18V)に立ち上げられる。その結果、NAND列NAND1a内のメモリトランジスタMT2はプログラム禁止電圧により消去状態に保持され、NAND列NAND1b内のメモリトランジスタMT2はプログラム電圧Vpgmによりデータプログラムがなされ、しきい値電圧は正方向にシフトして、たとえば消去状態の-3Vから2V程度になる。

【0088】上述した図12の実施例は、従来の主ビット線を介して非選択NAND列チャンネル部の電位をプログラム禁止電位まで充電する方式と比較して、低電圧動作に適しており、さらにデータラッチ回路のレイアウトも容易である。また、ワード線印加電圧の容量カップリングによりNAND列チャンネル部の電位を上昇させる従来のセルフブースト動作と比較して、プログラム禁止電位を充分高い電圧値(〜9V)に設定することが可能である。したがって、非選択メモリトランジスタに対するディスタープ耐性を向上させることができる。

【0089】以上説明したように、本第2実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置によれば、上述した第1実施例と同様に、低電圧動作に適し、さらにデータラッチ回路のレイアウトも容易となる。また、ワード線印加電圧の容量カップリングによりNAND列チャンネル部の電位を上昇させるセルフブースト動作と比較して、プログラム禁止電位を充分高い電圧値に設定することが可能である。そのために、データプログラム時のディスタープ耐性を向上させることができる。

【0090】第3実施例

図13は本発明に係る第3実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置の構成例を示す図である。図13の第3実施例の構成例が図1の第1実施例の構成例と異なる点は、主ビット線が対となって列方向に配線された第1副ビット線群および第2副ビット線群に階層化されたメモリアレイ構成をなしている点である。したがって、主ビット線のカラム方向のピッチを緩和できるため、アルミニウム配線と拡散層とのビットコンタクトおよびデータラッチ回路のレイアウトがさらに容易となり、好適である。

【0091】図13において、10Bはメモリアレイ、20はローデコード、30はデータラッチ回路、40はカラム選択部、および50は昇圧回路をそれぞれ示している。図13のNAND型不揮発性半導体記憶装置は、便宜上、2本の主ビット線、各主ビット線毎に階層化された一対の副ビット線群、各副ビット線群を構成する2本の副ビット線、各副ビット線毎に接続された2本のNAND列からなるメモリアレイを示す図であるが、実際のメモリアレイにおいては、たとえば64Mビットのメモリの場合、主ビット線は256バイト(約2k本)、各副ビット線群を構成する副ビット線は16本、各副ビット線毎に接続されたNAND列は64本、各NAND列に直列接続されるメモリトランジスタの個数は16個程度である。

【0092】メモリアレイ10Bにおいて、MBL1、MBL2は主ビット線を示し、主ビット線MBL1は副ビット線SBL1a、SBL1a'、および対となるSBL1b、SBL1b'に階層化され、主ビット線MBL2は副ビット線SBL2a、SBL2a'、および対となるSBL2b、SBL2b'に階層化されている。副ビット線SBL1aは接続トランジスタTG11aを介して主ビット線MBL1に接続され、接続トランジスタTG12aを介してプリチャージ線PCLに接続される。副ビット線SBL1a'は接続トランジスタTG11a'を介して主ビット線MBL1に接続され、接続トランジスタTG12a'を介してプリチャージ線PCLに接続される。副ビット線SBL1bは接続トランジスタTG11bを介して主ビット線MBL1に接続され、接続トランジスタTG12bを介してプリチャージ線PCLに接続される。副ビット線SBL1b'は接続トランジスタTG11b'を介して主ビット線MBL1に接続され、接続トランジスタTG12b'を介してプリチャージ線PCLに接続される。

【0093】副ビット線SBL2aは接続トランジスタTG21aを介して主ビット線MBL2に接続され、接続トランジスタTG22aを介してプリチャージ線PCLに接続される。副ビット線SBL2a'は接続トランジスタTG21a'を介して主ビット線MBL2に接続され、接続トランジスタTG22a'を介してプリチャ

ージ線PCLに接続される。副ビット線SBL2bは接続トランジスタTG21bを介して主ビット線MBL2に接続され、接続トランジスタTG22bを介してプリチャージ線PCLに接続される。副ビット線SBL2b'は接続トランジスタTG21b'を介して主ビット線MBL2に接続され、接続トランジスタTG22b'を介してプリチャージ線PCLに接続される。

【0094】接続トランジスタTG11a、TG21aは接続制御線TL1aにより制御され、接続トランジスタTG11b、TG21bは接続制御線TL1bにより制御され、接続トランジスタTG12a、TG22aは接続制御線TL2aにより制御され、接続トランジスタTG12b、TG22bは接続制御線TL2bにより制御され、接続トランジスタTG11a'、TG21a'は接続制御線TL1a'により制御され、接続トランジスタTG11b'、TG21b'は接続制御線TL1b'により制御され、接続トランジスタTG12a'、TG22a'は接続制御線TL2a'により制御され、接続トランジスタTG12b'、TG22b'は接続制御線TL2b'により制御される。

【0095】副ビット線SBL1aはNAND列NAND11aおよびNAND12aに接続され、副ビット線SBL1bはNAND列NAND11bおよびNAND12bに接続され、副ビット線SBL2aはNAND列NAND21aおよびNAND22aに接続され、副ビット線SBL2bはNAND列NAND21bおよびNAND22bに接続され、副ビット線SBL1a'はNAND列NAND11a'およびNAND12a'に接続され、副ビット線SBL1b'はNAND列NAND11b'およびNAND12b'に接続され、副ビット線SBL2a'はNAND列NAND21a'およびNAND22a'に接続され、副ビット線SBL2b'はNAND列NAND21b'およびNAND22b'に接続される。

【0096】各NAND列は選択トランジスタおよびメモリトランジスタが直列接続されてなり、それぞれ選択ゲート線SL(SL')およびワード線WL(WL')により制御される。主ビット線MBL1はデータラッチ回路SA1に接続され、主ビット線MBL2はデータラッチ回路SA2に接続されている。

【0097】50の昇圧回路は、データプログラム動作時に高電圧VPPおよび中間電圧VMを発生し、ローデコード20にプログラム電圧Vpgm(VPP)およびバス電圧Vpass(VM)を供給し、プリチャージ線PCLにプログラム禁止のプリチャージ電圧Vpc(VM)を供給する。

【0098】図14は、図13のNAND型不揮発性半導体記憶装置において、メモリアレイ10Bの具体的構成を示す図であるが、便宜上、2本の主ビット線と、各主ビット線毎に1対の副ビット線のみが図示されてい

る。

【0099】図14において、主ビット線MBL1は対となる副ビット線SBL1aおよびSBL1bに階層化され、主ビット線MBL2は対となる副ビット線SBL2aおよびSBL2bに階層化されている。副ビット線SBL1aは直列接続された接続トランジスタTG11aおよびバストランジスタPass-TRを介して主ビット線MBL1に接続され、接続トランジスタTG12aおよびバストランジスタPass-TRを介してプリチャージ線PCLに接続される。副ビット線SBL1bは直列接続された接続トランジスタTG11bおよびバストランジスタPass-TRを介して主ビット線MBL1に接続され、接続トランジスタTG12bおよびバストランジスタPass-TRを介してプリチャージ線PCLに接続される。副ビット線SBL2aは直列接続された接続トランジスタTG21aおよびバストランジスタPass-TRを介して主ビット線MBL2に接続され、接続トランジスタTG22aおよびバストランジスタPass-TRを介してプリチャージ線PCLに接続される。副ビット線SBL2bは直列接続された接続トランジスタTG21bおよびバストランジスタPass-TRを介して主ビット線MBL2に接続され、接続トランジスタTG22bおよびバストランジスタPass-TRを介してプリチャージ線PCLに接続される。

【0100】接続トランジスタTG11a、TG21aは接続制御線TL1aにより制御され、接続トランジスタTG11b、TG21bは接続制御線TL1bにより制御され、接続トランジスタTG12a、TG22aは接続制御線TL2aにより制御され、接続トランジスタTG12b、TG22bは接続制御線TL2bにより制御される。各接続トランジスタに直列接続されるバストランジスタPass-TRは、チャンネル部にリン等のN型不純物層が形成されており、接続制御線に印加する電圧にかかわらず常にオン状態となる。副ビット線SBL1aはNAND列NAND11aおよびNAND12aに接続され、副ビット線SBL1bはNAND列NAND11bおよびNAND12bに接続され、副ビット線SBL2aはNAND列NAND21aおよびNAND22aに接続され、副ビット線SBL2bはNAND列NAND21bおよびNAND22bに接続される。

【0101】各NAND列はそれぞれ2個の選択トランジスタST1、ST2、および4個のメモリトランジスタMT1~MT4が直列接続されて構成されている。NAND列NAND11a、NAND11b、NAND21aおよびNAND21bにおいて、選択トランジスタST1は選択ゲート線SL11により制御され、選択トランジスタST2は選択ゲート線SL12により制御され、またメモリトランジスタMT1~MT4はそれぞれワード線WL11~WL14により制御される。また、NAND列NAND12a、NAND12b、NA

ND22aおよびNAND22bにおいて、選択トランジスタST1は選択ゲート線SL21により制御され、選択トランジスタST2は選択ゲート線SL22により制御され、またメモリトランジスタMT1~MT4はそれぞれワード線WL21~WL24により制御される。なお、図13の構成においては、便宜上、NAND列1本に4個のメモリトランジスタが直列接続されているが、実際の構成においては、1本のNAND列に直列接続されるメモリトランジスタの個数は~16個程度である。

【0102】図15は図14のNAND型不揮発性半導体記憶装置のパターンレイアウト図である。また、図16(a)、(b)はデバイス構造断面図であり、図16(a)は図15におけるA-A'線方向からの、図16(b)はB-B'線方向からの断面図を示している。

【0103】図15および図16(a)、(b)において、100は半導体基板、101はメモリアレイ領域が形成されるP型ウェル領域、102はメモリトランジスタのソースおよびドレインN型拡散層、103はVSS配線およびビットコンタクト部のN型拡散層、103aはバストランジスタのチャンネル部に形成されたN型拡散層、104はトンネル酸化膜、105は選択トランジスタ部のゲート酸化膜、105aはLOCOS素子分離酸化膜、106はフローティングゲート電極をなす第1層目ポリシリコンゲート電極、107はONO-3層絶縁膜、108はメモリトランジスタおよび選択トランジスタの制御ゲート電極をなす第2層目ポリシリコン配線、109は第3層目ポリシリコン配線下の層間絶縁膜、110は第3層目ポリシリコン配線下のコンタクトホール、111は副ビット線およびプリチャージ線をなす3層目ポリシリコン配線、112はアルミニウム配線下の層間絶縁膜、113はアルミニウム配線下のコンタクトホール、および114は主ビット線をなすアルミニウム配線をそれぞれ示している。

【0104】次に、図13および図14のNAND型不揮発性半導体記憶装置におけるデータプログラム動作について図17に関連付けて説明する。図17は、ワード線WL12を選択してページプログラムを行い、かつ副ビット線SBL1aおよびSBL2aを選択して副ビット線SBL1bおよびSBL2bを選択しない場合に、NAND列NAND11a内のMT2がプログラムを禁止すべきメモリトランジスタであり、NAND列NAND21a内のMT2がプログラムすべきメモリトランジスタである場合の動作を説明するための図である。この場合、ワード線WL12に接続されたメモリトランジスタにおいて、NAND列NAND21a内のメモリトランジスタMT2のみデータプログラムを行い、その他のNAND列NAND11a、NAND11bおよびNAND21b内のメモリトランジスタMT2はすべてデータプログラムを禁止する必要がある。

【0105】まず、接続制御線TL1aおよびTL1bに接地電圧GND(0V)が印加され副ビット線SBL1a、SBL1b、SBL2aおよびSBL2bがすべて対応する主ビット線MBL1およびMBL2から切り離された状態で、接続制御線TL2aおよびTL2bにバス電圧Vpass(9V)が印加される。これにより、副ビット線SBL1a、SBL1b、SBL2aおよびSBL2bがプリチャージ線PCLからすべてプログラム禁止のプリチャージ電圧(9V)に充電される。同時に、選択ゲート線SL12に接地電圧GND(0V)が印加され、選択ゲート線SL11およびワード線WL11~WL14にバス電圧Vpass(9V)が印加される。これにより、NAND列NAND11a、NAND11b、NAND21aおよびNAND21bのチャンネル部がすべて副ビット線を介してプログラム禁止電圧(9V)まで充電される。このとき、非選択ブロックのNAND列NAND12a、NAND12b、NAND22aおよびNAND22bにおいては、選択ゲート線SL21、SL22およびワード線WL21~WL24に接地電圧GND(0V)が印加されているので、当該NAND列は副ビット線と切り離され、メモリトランジスタには電圧が印加されていない状態である。

【0106】次に、接続制御線TL2aおよびTL2bが接地電圧GND(0V)に立ち下げられて副ビット線SBL1a、SBL1b、SBL2aおよびSBL2bがすべてプリチャージ線PCLから切り離された状態で、接続制御線TL1aが電源電圧VCC(3.3V)に立ち上げられて副ビット線SBL1aおよびSBL2aが主ビット線MBL1およびMBL2に接続される。ここで、プログラムを禁止すべきメモリトランジスタ(NAND11a内のMT2)が接続された主ビット線MBL1は電源電圧VccVCC(3.3V)に、プログラムすべきメモリトランジスタ(NAND21a内のMT2)が接続された主ビット線MBL2は接地電圧GND(0V)に、それぞれ対応するデータラッチ回路を介して設定されている。その結果、NAND列NAND11a、NAND11bおよびNAND21bのチャンネル部および対応する副ビット線はフローティング状態のままプログラム禁止電位に保持されるが、NAND列NAND21aのチャンネル部および副ビット線SBL2aのプログラム禁止電位は主ビット線MBL2に放電される。同時に、選択ワード線WL12の印加電圧がプログラム電圧Vpgm(18V)に立ち上げられる。その結果、NAND列NAND11a、NAND11bおよびNAND21b内のメモリトランジスタMT2はプログラム禁止電圧により消去状態に保持され、NAND列NAND21a内のメモリトランジスタMT2はプログラム電圧Vpgmによりデータプログラムがなされ、しきい値電圧は正方向にシフトして、たとえば消去状態の-3Vから2V程度になる。

【0107】上述した図17の実施例は、従来の主ビット線を介して非選択NAND列チャンネル部の電位をプログラム禁止電位まで充電する方式に比較して、充電容量を大幅に減少させることができることから低電圧動作に適するだけでなく、さらに主ビット線のカラム方向のピッチを緩和できるため、アルミニウム配線と拡散層とのビットコンタクトおよびデータラッチ回路のレイアウトが容易となる。また、ワード線印加電圧の容量カップリングによりNAND列チャンネル部の電位を上昇させる従来のセルフブースト動作と比較して、プログラム禁止電位を充分高い電圧値（～9V）に設定することが可能である。したがって、非選択メモリトランジスタに対するディスタブ耐性を向上させることができる。

【0108】図18は、上述した図17に関連付けて説明した動作のタイミングチャートを示す図である。以下、図17のデータプログラム動作を、図18のタイミングチャートを参照しながらさらに詳細に説明する。

【0109】まず図18において、(a)に示すφP/Rはプログラム/ベリファイ制御信号であり、図中時刻t1～t4の間は第1回目のプログラム/ベリファイ動作が行われ、また時刻t4～t7の間は第2回目のプログラム/ベリファイ動作が行われる。

【0110】まず時刻t1で第1回目のプログラム動作が開始されて、図18(b)および(e)に示すように、接続制御線TL1aおよびTL1bおよび選択ゲート線SL12に接地電圧GND(0V)が印加され、図18(c)、(d)および(f)に示すように、接続制御線TL2aおよびTL2bおよび選択ゲート線SL11およびすべてのワード線WLにパス電圧Vpass(9V)が印加される。その結果、図18(h)に示すように、NAND列NAND11aのチャンネル部電位VCH11aおよびNAND11bのチャンネル部電位VCH11bおよびNAND21aのチャンネル部電位VCH21aおよびNAND21bのチャンネル部電位VCH21bは、すべて対応する副ビット線およびプリチャージ線を介してプログラム禁止電圧(9V)まで充電される。

【0111】次に、図18(b)、(c)に示すように、時刻t2で、接続制御線TL2aおよびTL2bが接地電圧GND(0V)に立ち下げられ、接続制御線TL1aが電源電圧VCC(3.3V)に立ち上げられる。その結果、プログラムを禁止すべきメモリトランジスタが在するチャンネル部電位VCH11a、VCH11bおよびVCH21bはフローティング状態のままプログラム禁止電位を保持するが、プログラムすべきメモリトランジスタが在するVCH21aのプログラム禁止電位は主ビット線に放電されてGND(0V)になる。一方、図18(f)に示すように、選択ワード線にはプログラム電圧Vpgm(18V)が印加され、時刻t2～t3の間において、当該ワード線に接続されたメモリ

トランジスタ一括にページプログラムが行われる。

【0112】次に時刻t3～t4の間は、第1回目のベリファイ動作期間であり、図18(d)、(f)に示すように、接続制御線TL1b、TL2b並びに選択ワード線WLに接地電圧GNDが印加され、図18(b)、(g)および(e)に示すように、接続制御線TL1aおよびすべての非選択ワード線および選択ゲート線SL11およびSL12に電源電圧VCCが印加されてバス状態として、選択する一方の副ビット線側のみ通常のNAND型フラッシュメモリと同様のベリファイ動作が行われる。また、時刻t4～t7の間は第2回目のプログラム/ベリファイ動作であり、第1回目のプログラム/ベリファイ動作のまったくの繰り返しである。

【0113】図19は、図13～図18の本第3実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置において、すでに説明したプログラム動作、および消去動作、読み出し動作についての、各バイアス設定を示す図である。なお図中、プログラム動作は便宜上プリチャージ時(図18において時刻t1～t2)と実プログラム時(図18において時刻t2～t3)に分けて示されている。

【0114】図19において、プログラム動作はすでに説明したとおりであり、再度の説明を省略する。消去動作については、従来のNAND型フラッシュメモリと基本的に同様であり、選択NAND列ブロックの全ワード線に0V、非選択NAND列ブロックの全ワード線およびメモリアレイの基板PWE L Lに高電圧(Verase=22V)が印加される。その結果、選択NAND列ブロックのメモリトランジスタのみ、フローティングゲートから基板に電子が引き抜かれて、メモリトランジスタのしきい値電圧は負方向にシフトして、たとえば-3V程度になる。読み出し動作についても、従来のNAND型フラッシュメモリと基本的に同様であり、選択NAND列ブロックにおいては、選択ワード線に接地電圧GNDが印加され、すべての非選択ワード線および選択ゲート線SLおよび選択接続制御線TL1aに電源電圧VCCが印加されてバス状態として、通常のNAND型フラッシュメモリと同様の読み出し動作が行われる。

【0115】以上説明したように、本第3実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置によれば、主ビット線が対となって列方向に配線された第1副ビット線群および第2副ビット線群に階層化されたメモリアレイ構成をなし、非選択側の副ビット線から充電したNAND列チャンネル部のプログラム禁止電位を保持したまま、選択側の副ビット線から充電したNAND列に対して選択的にページプログラムを行う。したがって、従来の主ビット線を介して非選択NAND列チャンネル部の電位をプログラム禁止電位まで充電する方式に比較して、充電容量を大幅に減少させることができることから低電圧動作に適するだけでなく、さらに主ビット線のカラム方向のピッチを緩和できるため、アルミニウム配線と拡散層との

ビットコンタクトおよびデータラッチ回路のレイアウトも容易となる。また、ワード線印加電圧の容量カップリングによりNAND列チャンネル部の電位を上昇させるセルフブースト動作と比較して、プログラム禁止電位を充分高い電圧値に設定することが可能である。そのために、データプログラム時のディスタブ耐性を向上させることができる。

【0116】第4実施例

図20は本発明に係る第4実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置の構成例を示す図である。

【0117】図20のNAND型不揮発性半導体記憶装置は、メモリアレイ10C、ローデコーダ20、データラッチ回路群30、およびカラム選択部40により構成されている。図20のNAND型不揮発性半導体記憶装置は、便宜上、2本の主ビット線、各主ビット線毎に階層化された一対の副ビット線群、各副ビット線群を構成する2本の副ビット線、各副ビット線毎に接続された2本のNAND列からなるメモリアレイを示す図であるが、実際のメモリアレイにおいては、例えば64Mビットのメモリの場合、主ビット線は256バイト（約2k本）、各副ビット線群を構成する副ビット線は16本、各副ビット線毎に接続されたNAND列は64本、各NAND列に直接続されるメモリトランジスタの個数は16個程度である。

【0118】メモリアレイ10Cにおいて、MBL1、MBL2は主ビット線を示し、主ビット線MBL1は副ビット線SBL1a、SBL1a'、および対となるSBL1b、SBL1b'に階層化され、主ビット線MBL2は副ビット線SBL2a、SBL2a'、および対となるSBL2b、SBL2b'に階層化されている。副ビット線SBL1aは接続トランジスタTG1aを介して主ビット線MBL1に接続される。副ビット線SBL1a'は接続トランジスタTG1a'を介して主ビット線MBL1に接続される。副ビット線SBL1bは接続トランジスタTG1bを介して主ビット線MBL1に接続される。副ビット線SBL1b'は接続トランジスタTG1b'を介して主ビット線MBL1に接続される。副ビット線SBL2aは接続トランジスタTG2aを介して主ビット線MBL2に接続される。副ビット線SBL2a'は接続トランジスタTG2a'を介して主ビット線MBL2に接続される。副ビット線SBL2bは接続トランジスタTG2bを介して主ビット線MBL2に接続される。副ビット線SBL2b'は接続トランジスタTG2b'を介して主ビット線MBL2に接続される。

【0119】接続トランジスタTG1a、TG2aは接続制御線TL1aにより制御され、接続トランジスタTG1b、TG2bは接続制御線TL1bにより制御され、接続トランジスタTG1a'、TG2a'は接続制御線TL1a'により制御され、接続トランジスタTG

1b'、TG2b'は接続制御線TL1b'により制御される。副ビット線SBL1aはNAND列NAND11aおよびNAND12aに接続され、副ビット線SBL1bはNAND列NAND11bおよびNAND12bに接続され、副ビット線SBL2aはNAND列NAND21aおよびNAND22aに接続され、副ビット線SBL2bはNAND列NAND21bおよびNAND22bに接続され、副ビット線SBL1a'はNAND列NAND11a'およびNAND12a'に接続され、副ビット線SBL1b'はNAND列NAND11b'およびNAND12b'に接続され、副ビット線SBL2a'はNAND列NAND21a'およびNAND22a'に接続され、副ビット線SBL2b'はNAND列NAND21b'およびNAND22b'に接続される。各NAND列は選択トランジスタおよびメモリトランジスタが直列接続されてなり、それぞれ選択ゲート線SL(SL')およびワード線WL(WL')に制御される。主ビット線MBL1はデータラッチ回路SA1に接続、主ビット線MBL2はデータラッチ回路SA2に接続されている。

【0120】図21は、図20のNAND型不揮発性半導体記憶装置において、メモリアレイ10Cの具体的構成を示す図であるが、便宜上、2本の主ビット線と、各主ビット線毎に1対の副ビット線のみが図示されている。

【0121】図21において、主ビット線MBL1は対となる副ビット線SBL1aおよびSBL1bに階層化され、主ビット線MBL2は対となる副ビット線SBL2aおよびSBL2bに階層化されている。副ビット線SBL1aは接続トランジスタTG1aおよびパストランジスタPass-TRを介して主ビット線MBL1に接続される。副ビット線SBL1bは接続トランジスタTG1bおよびパストランジスタPass-TRを介して主ビット線MBL1に接続される。副ビット線SBL2aは接続トランジスタTG2aおよびパストランジスタPass-TRを介して主ビット線MBL2に接続される。副ビット線SBL2bは接続トランジスタTG2bおよびパストランジスタPass-TRを介して主ビット線MBL2に接続される。

【0122】接続トランジスタTG1a、TG2aは接続制御線TL1aにより制御され、接続トランジスタTG1b、TG2bは接続制御線TL1bにより制御される。各接続トランジスタに直列接続されるパストランジスタPass-TRは、チャンネル部にリン等のN型不純物層が形成されており、接続制御線に印加する電圧に係らず常にオン状態となる。したがって、図21のメモリアレイにおいては、接続制御線TL1aがハイレベルであり、接続制御線TL1bがローレベルである場合には、副ビット線SBL1aが主ビット線MBL1に接続され、副ビット線SBL2aが主ビット線MBL2に接

続される。また、接続制御線 TL1b がハイレベルであり、接続制御線 TL1a がローレベルである場合には、副ビット線 SBL1b が主ビット線 MBL1 に接続され、副ビット線 SBL2b が主ビット線 MBL2 に接続される。副ビット線 SBL1a は NAND 列 NAND11a および NAND12a に接続され、副ビット線 SBL1b は NAND 列 NAND11b および NAND12b に接続され、副ビット線 SBL2a は NAND 列 NAND21a および NAND22a に接続され、副ビット線 SBL2b は NAND 列 NAND21b および NAND22b に接続される。

【0123】各 NAND 列はそれぞれ 2 個の選択トランジスタ ST1、ST2、および 4 個のメモリトランジスタ MT1～MT4 が直列接続されて構成される。NAND 列 NAND11a、NAND11b、NAND21a および NAND21b において、選択トランジスタ ST1 は選択ゲート線 SL11 により制御され、選択トランジスタ ST2 は選択ゲート線 SL12 により制御され、またメモリトランジスタ MT1～MT4 はそれぞれワード線 WL11～WL14 により制御される。NAND 列 NAND12a、NAND12b、NAND22a および NAND22b において、選択トランジスタ ST1 は選択ゲート線 SL21 により制御され、選択トランジスタ ST2 は選択ゲート線 SL22 により制御され、またメモリトランジスタ MT1～MT4 はそれぞれワード線 WL21～WL24 により制御される。なお、図 21 の構成においては、便宜上、NAND 列 1 本に 4 個のメモリトランジスタが直列接続されているが、実際の構成においては、1 本の NAND 列に直列接続されるメモリトランジスタの個数は～16 個程度である。

【0124】図 22 は図 21 の NAND 型不揮発性半導体記憶装置のパターンレイアウト図である。また、図 23 (a)～(b) はデバイス構造断面図であり、図 23 (a) は A-A' 方向からの、図 23 (b) は B-B' 方向からの断面図を示している。

【0125】図 22 および図 23 (a)、(b) において、100 は半導体基板、101 はメモリアレイ領域が形成される P 型ウェル領域、102 はメモリトランジスタのソースおよびドレイン N 型拡散層、103 は VSS 配線およびビットコンタクト部の N 型拡散層、103a はパストランジスタのチャンネル部に形成された N 型拡散層、104 はトンネル酸化膜、105 は選択トランジスタ部のゲート酸化膜、105a は LOCOS 素子分離酸化膜、106 はフローティングゲート電極をなす第 1 層目ポリシリコンゲート電極、107 は ONO-3 層絶縁膜、108 はメモリトランジスタおよび選択トランジスタの制御ゲート電極をなす第 2 層目ポリシリコン配線、109 は第 3 層目ポリシリコン配線下の層間絶縁膜、110 は第 3 層目ポリシリコン配線下のコンタクトホール、111 は副ビット線をなす 3 層目ポリシリコン

配線、112 はアルミニウム配線下の層間絶縁膜、113 はアルミニウム配線下のコンタクトホール、114 は主ビット線をなすアルミニウム配線をそれぞれ示している。

【0126】図 22 のパターンレイアウト図において、副ビット線をなす第 3 層目ポリシリコン配線 (111) および当該副ビット線とのビットコンタクト (110) のカラム方向のピッチは、従来のビット線ピッチに比して緩和されていない。しかし、ポリシリコン配線およびコンタクトのプロセス上の微細加工は、アルミニウム配線およびコンタクトのプロセス上の微細加工よりも容易であるため、従来のビット線構成よりもセルサイズのシェリングに有利である。

【0127】以上説明したように、本第 4 実施例の NAND 型不揮発性半導体記憶装置によれば、主ビット線が複数の列方向に複数群の副ビット線群に階層化されたメモリアレイ構成をなしている。したがって、主ビット線のカラム方向のピッチを緩和できるため、アルミニウム配線と拡散層とのビットコンタクトおよびデータラッチ回路のレイアウトが容易となる。

【0128】第 5 実施例

図 24 は本発明に係る第 5 実施例の NAND 型不揮発性半導体記憶装置の構成例を示す図である。図 24 の第 5 実施例の構成例が図 20 の第 4 実施例の構成例と異なる点は、対となって列方向に配線された副ビット線対が、それぞれ反対側の端部で接続トランジスタを介して主ビット線に接続されるメモリアレイ構成をなしている点である。したがって、第 4 実施例において必要であったパストランジスタ Pass-TR が不要となり、プロセス工程 (103a の N 型拡散層) が削減でき、好適である。

【0129】図 24 の NAND 型不揮発性半導体記憶装置は、メモリアレイ 10D、ローデコーダ 20、データラッチ回路群 30、およびカラム選択部 40 により構成されている。図 24 の NAND 型不揮発性半導体記憶装置は、便宜上、2 本の主ビット線、各主ビット線毎に階層化された一対の副ビット線群、各副ビット線群を構成する 2 本の副ビット線、各副ビット線毎に接続された 2 本の NAND 列からなるメモリアレイを示す図であるが、実際のメモリアレイにおいては、例えば 64 Mビットのメモリの場合、主ビット線は 256 バイト (約 2 k 本)、各副ビット線群を構成する副ビット線は 16 本、各副ビット線毎に接続された NAND 列は 64 本、各 NAND 列に直列接続されるメモリトランジスタの個数は 16 個程度である。

【0130】メモリアレイ 10D において、MBL1、MBL2 は主ビット線を示し、主ビット線 MBL1 は副ビット線 SBL1a、SBL1a'、および対となる SBL1b、SBL1b' に階層化され、主ビット線 MBL2 は副ビット線 SBL2a、SBL2a'、および対

となるSBL2b、SBL2b'に階層化されている。副ビット線SBL1aは接続トランジスタTG1aを介して主ビット線MBL1に接続される。副ビット線SBL1a'は接続トランジスタTG1a'を介して主ビット線MBL1に接続される。副ビット線SBL1bは接続トランジスタTG1bを介して主ビット線MBL1に接続される。副ビット線SBL1b'は接続トランジスタTG1b'を介して主ビット線MBL1に接続される。副ビット線SBL2aは接続トランジスタTG2aを介して主ビット線MBL2に接続される。副ビット線SBL2a'は接続トランジスタTG2a'を介して主ビット線MBL2に接続される。副ビット線SBL2bは接続トランジスタTG2bを介して主ビット線MBL2に接続される。副ビット線SBL2b'は接続トランジスタTG2b'を介して主ビット線MBL2に接続される。

【0131】接続トランジスタTG1a、TG2aは接続制御線TL1aにより制御され、接続トランジスタTG1b、TG2bは接続制御線TL1bにより制御され、接続トランジスタTG1a'、TG2a'は接続制御線TL1a'により制御され、接続トランジスタTG1b'、TG2b'は接続制御線TL1b'により制御される。副ビット線SBL1aはNAND列NAND11aおよびNAND12aに接続され、副ビット線SBL1bはNAND列NAND11bおよびNAND12bに接続され、副ビット線SBL2aはNAND列NAND21aおよびNAND22aに接続され、副ビット線SBL2bはNAND列NAND21bおよびNAND22bに接続され、副ビット線SBL1a'はNAND列NAND11a'およびNAND12a'に接続され、副ビット線SBL1b'はNAND列NAND11b'およびNAND12b'に接続され、副ビット線SBL2a'はNAND列NAND21a'およびNAND22a'に接続され、副ビット線SBL2b'はNAND列NAND21b'およびNAND22b'に接続される。各NAND列は選択トランジスタおよびメモリトランジスタが直列接続されてなり、それぞれ選択ゲート線SL(SL')およびワード線WL(WL')に制御される。主ビット線MBL1はデータラッチ回路SA1に接続され、主ビット線MBL2はデータラッチ回路SA2に接続されている。

【0132】図25は、図24のNAND型不揮発性半導体記憶装置において、メモリアレイ10Dの具体的構成を示す図であるが、便宜上、2本の主ビット線と、各主ビット線毎に1対の副ビット線のみが図示されている。

【0133】図25において、主ビット線MBL1は対となる副ビット線SBL1aおよびSBL1bに階層化され、主ビット線MBL2は対となる副ビット線SBL2aおよびSBL2bに階層化されている。副ビット線

SBL1aは接続トランジスタTG1aを介して主ビット線MBL1に接続される。副ビット線SBL1bは接続トランジスタTG1bを介して主ビット線MBL1に接続される。副ビット線SBL2aは接続トランジスタTG2aを介して主ビット線MBL2に接続される。副ビット線SBL2bは接続トランジスタTG2bを介して主ビット線MBL2に接続される。

【0134】接続トランジスタTG1a、TG2aは接続制御線TL1aにより制御され、接続トランジスタTG1b、TG2bは接続制御線TL1bにより制御される。図25のメモリアレイにおいては、接続制御線TL1aがハイレベルであり、接続制御線TL1bがローレベルである場合には、副ビット線SBL1aが主ビット線MBL1に接続され、副ビット線SBL2aが主ビット線MBL2に接続される。また、接続制御線TL1bがハイレベルであり、接続制御線TL1aがローレベルである場合には、副ビット線SBL1bが主ビット線MBL1に接続され、副ビット線SBL2bが主ビット線MBL2に接続される。副ビット線SBL1aはNAND列NAND11aおよびNAND12aに接続され、副ビット線SBL1bはNAND列NAND11bおよびNAND12bに接続され、副ビット線SBL2aはNAND列NAND21aおよびNAND22aに接続され、副ビット線SBL2bはNAND列NAND21bおよびNAND22bに接続される。

【0135】各NAND列はそれぞれ2個の選択トランジスタST1、ST2、および4個のメモリトランジスタMT1~MT4が直列接続されて構成されている。NAND列NAND11a、NAND11b、NAND21aおよびNAND21bにおいて、選択トランジスタST1は選択ゲート線SL11により制御され、選択トランジスタST2は選択ゲート線SL12により制御され、またメモリトランジスタMT1~MT4はそれぞれワード線WL11~WL14により制御される。NAND列NAND12aおよびNAND12bおよびNAND22aおよびNAND22bにおいて、選択トランジスタST1は選択ゲート線SL21により制御され、選択トランジスタST2は選択ゲート線SL22により制御され、またメモリトランジスタMT1~MT4はそれぞれワード線WL21~WL24により制御される。なお、図25の構成においては、便宜上、NAND列1本に4個のメモリトランジスタが直列接続されているが、実際の構成においては、1本のNAND列に直列接続されるメモリトランジスタの個数は~16個程度である。

【0136】図26は図25のNAND型不揮発性半導体記憶装置のパターンレイアウト図である。また、図27(a)、(b)はデバイス構造断面図であり、図27(a)はA-A'方向からの、図27(b)はB-B'方向からの断面図を示している。

【0137】図26および図27(a), (b)において、100は半導体基板、101はメモリアレイ領域が形成されるP型ウェル領域、102はメモリトランジスタのソースおよびドレインN型拡散層、103はVSS配線およびビットコンタクト部のN型拡散層、104はトンネル酸化膜、105は選択トランジスタ部のゲート酸化膜、105aはLOCOS素子分離酸化膜、106はフローティングゲート電極をなす第1層目ポリシリコンゲート電極、107はONO-3層絶縁膜、108はメモリトランジスタおよび選択トランジスタの制御ゲート電極をなす第2層目ポリシリコン配線、109は第3層目ポリシリコン配線下の層間絶縁膜、110は第3層目ポリシリコン配線下のコンタクトホール、111は副ビット線をなす3層目ポリシリコン配線、112はアルミニウム配線下の層間絶縁膜、113はアルミニウム配線下のコンタクトホール、114は主ビット線をなすアルミニウム配線をそれぞれ示している。

【0138】図26のパターンレイアウト図において、副ビット線をなす第3層目ポリシリコン配線(111)および当該副ビット線とのビットコンタクト(110)のカラム方向のピッチは、従来のビット線ピッチに比して緩和されていない。しかし、ポリシリコン配線およびコンタクトのプロセス上の微細加工は、アルミニウム配線およびコンタクトのプロセス上の微細加工よりも容易であるため、従来のビット線構成よりもセルサイズのシェリングに有利である。

【0139】以上説明したように、本第4実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置によれば、主ビット線が複数の列方向に複数群の副ビット線群に階層化されたメモリアレイ構成をなしている。したがって、主ビット線のカラム方向のピッチを緩和できるため、アルミニウム配線と拡散層とのビットコンタクトおよびデータラッチ回路のレイアウトが容易となる。またすでに説明した第4実施例と比較して、プロセス工程が削減でき、好適である。

【0140】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、低電圧での単一電源動作に適し、ビット線毎のデータラッチ回路のレイアウトが容易で、しかもディスタープ耐性の良好なデータプログラム動作を行うNAND型不揮発性半導体記憶装置を実現することができる。さらに、本発明によれば、実質的にメモリセルサイズを大きくすることなく、ビット線レイアウトのカラム方向のピッチを緩和できるNAND型不揮発性半導体記憶装置を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る第1実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置の構成例を示す図である。

【図2】図1におけるメモリアレイの具体的構成を示す図である。

【図3】図2のパターンレイアウト図である。

【図4】図3のパターンレイアウト図におけるデバイス構造断面図である。

【図5】第1実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置におけるデータプログラム動作を説明するための図である。

【図6】図5の動作を説明するためのタイミングチャートを示す図である。

【図7】第1実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置において、プログラム動作、消去動作、読み出し動作についての各バイアス設定を示す図である。

【図8】本発明に係る第2実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置の構成例を示す図である。

【図9】図8におけるメモリアレイの具体的構成を示す図である。

【図10】図9のパターンレイアウト図である。

【図11】図10のパターンレイアウト図におけるデバイス構造断面図である。

【図12】第2実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置におけるデータプログラム動作を説明するための図である。

【図13】本発明に係る第3実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置の構成例を示す図である。

【図14】図13におけるメモリアレイの具体的構成を示す図である。

【図15】図14のパターンレイアウト図である。

【図16】図15のパターンレイアウト図におけるデバイス構造断面図である。

【図17】第3実施形態のNAND型不揮発性半導体記憶装置におけるデータプログラム動作を説明するための図である。

【図18】図17の動作を説明するためのタイミングチャートを示す図である。

【図19】第3実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置において、プログラム動作、消去動作、読み出し動作についての各バイアス設定を示す図である。

【図20】本発明に係る第4実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置の構成例を示す図である。

【図21】図20におけるメモリアレイの具体的構成を示す図である。

【図22】図21のパターンレイアウト図である。

【図23】図22のパターンレイアウト図におけるデバイス構造断面図である。

【図24】本発明に係る第5実施例のNAND型不揮発性半導体記憶装置の構成例を示す図である。

【図25】図24におけるメモリアレイの具体的構成を示す図である。

【図26】図25のパターンレイアウト図である。

【図27】図26のパターンレイアウト図におけるデバイス構造断面図である。

【図28】セルフブーストによるデータプログラムの動作を説明するための図である。

【図29】図29(a)はセルフブースト動作時における1個のメモリトランジスタを図示したものであり、図29(b)はその等価回路図である。

【図30】セルフブースト効率 B_r の確保とトランジスタの短チャンネル化が、相反するトレードオフの関係にあることを説明するための図である。

【図31】カラム方向のピッチを緩和できる従来のNAND型フラッシュメモリのメモリアレイを示す図である。

【図32】図31のパターンレイアウト図である。

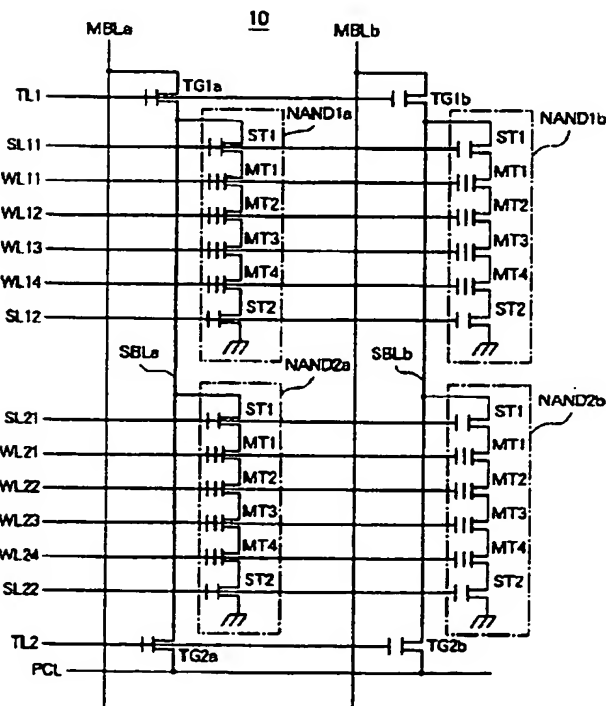
【図33】図32のパターンレイアウト図におけるデバイス構造断面図である。

【符号の説明】

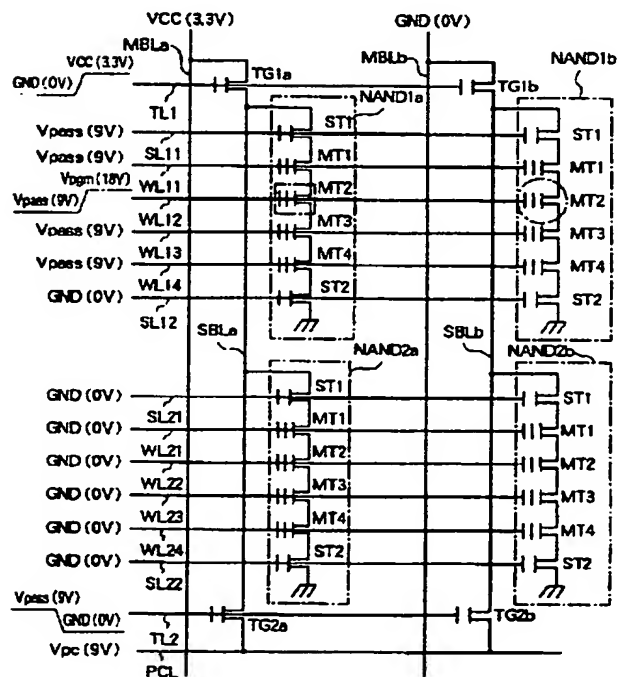
SL…選択ゲート線、WL…ワード線、BL…ビット線、MBL…主ビット線、SBL…副ビット線、TL…接続制御線、PCL…プリチャージ線、ST…選択トランジスタ、MT…メモリトランジスタ、TG…接続トランジスタ、Pass-TR…パストランジスタ、NAND…NAND列、SA…データラッチ回路、V_{pgm}…プログラム電圧、V_{pass}…パス電圧、V_{bst}…ブースト電圧（プログラム禁止電圧）、V_{pc}…プリチャージ電圧（プログラム禁止電圧）、V_{PP}…高電圧、V_M…中間電圧、V_{CH}…NAND列チャンネル電位、V

F…フローティングゲート電位、V_C…コントロールゲート電位、 $\phi P/R$ …プログラム/ペリファイ制御信号、C_{ono}…コントロールゲート/フローティングゲート間の層間容量、C_{tox}…トンネル酸化膜容量、C_{ch}…チャンネル部容量、C_{ins}…C_{ono}とC_{tox}の直列接続による合成容量、B_r…セルフブースト効率、N_{dope}…P_{WELL}濃度、L_{min}…TRの短チャンネル限界、10、10a、10B、10C、10D…メモリアレイ、20…ローデコード、30…データラッチ回路、40…カラム選択部、50…昇圧回路、100…半導体基板、101…P型ウェル領域、102…N型拡散層（メモリトランジスタのソースおよびドレイン）、103…N型拡散層（VSS配線およびビットコンタクト部）、103a…N型拡散層（パストランジスタのチャンネル部）、104…トンネル酸化膜、105…ゲート酸化膜（選択トランジスタ部）、105a…LOCOS素子分離酸化膜、106…第1層目ポリシリコンゲート電極、107…ONO-3層絶縁膜、108…第2層目ポリシリコン配線、109…層間絶縁膜（第3層目ポリシリコン配線下）、110…コンタクトホール（第3層目ポリシリコン配線下）、111…第3層目ポリシリコン配線、112…層間絶縁膜（アルミニウム配線下）、113…コンタクトホール（アルミニウム配線下）、114…アルミニウム配線。

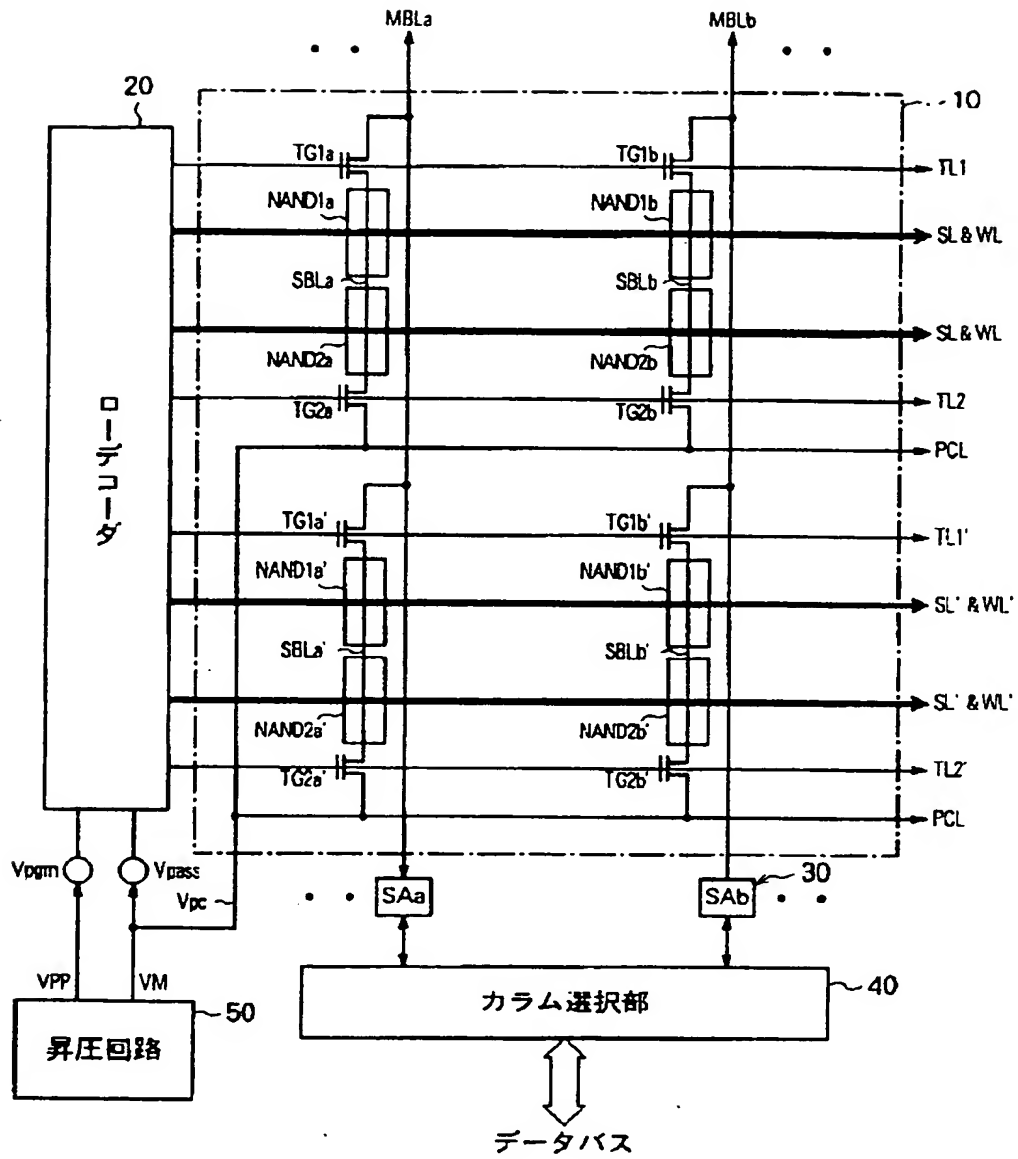
【図2】



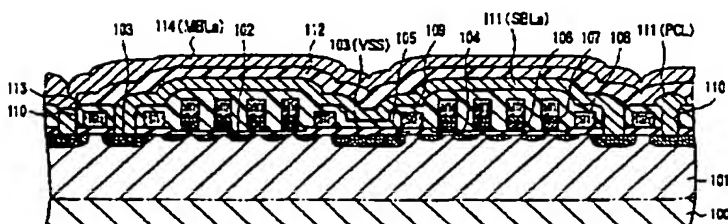
【図5】



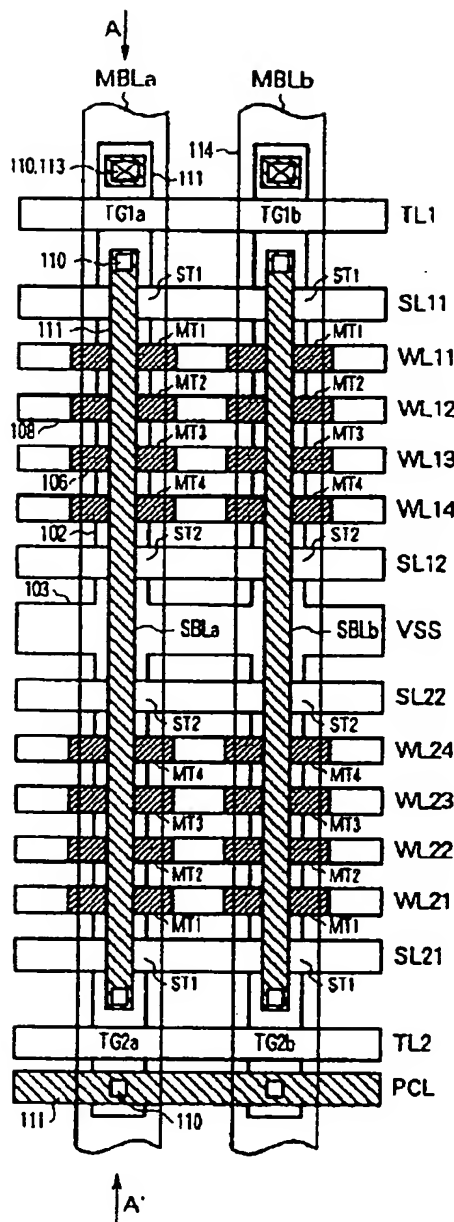
【図1】



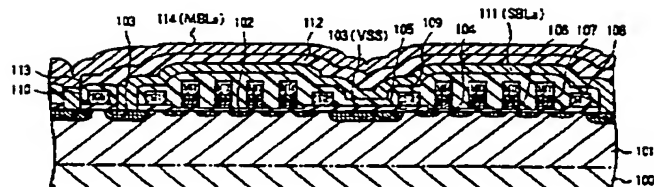
【図4】



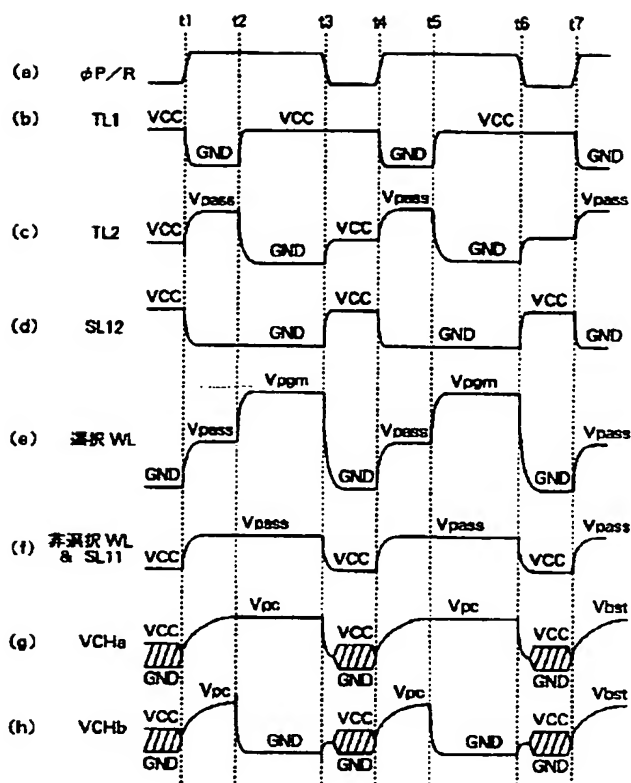
【图 3】



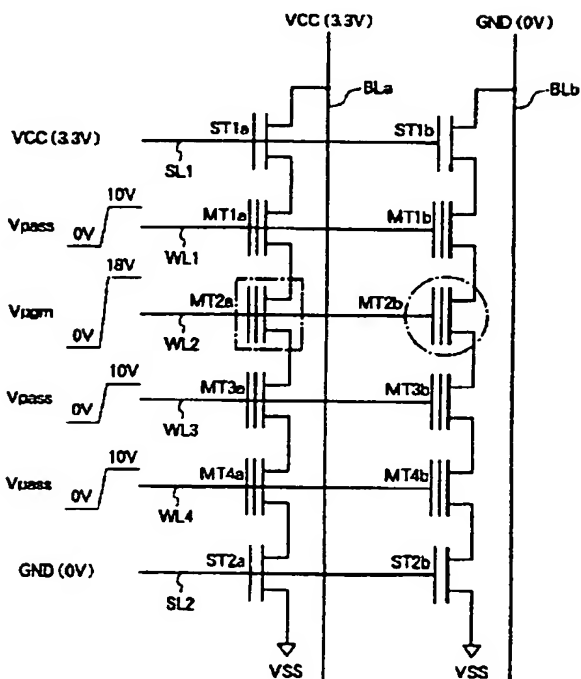
【図 1 1】



【图 6】



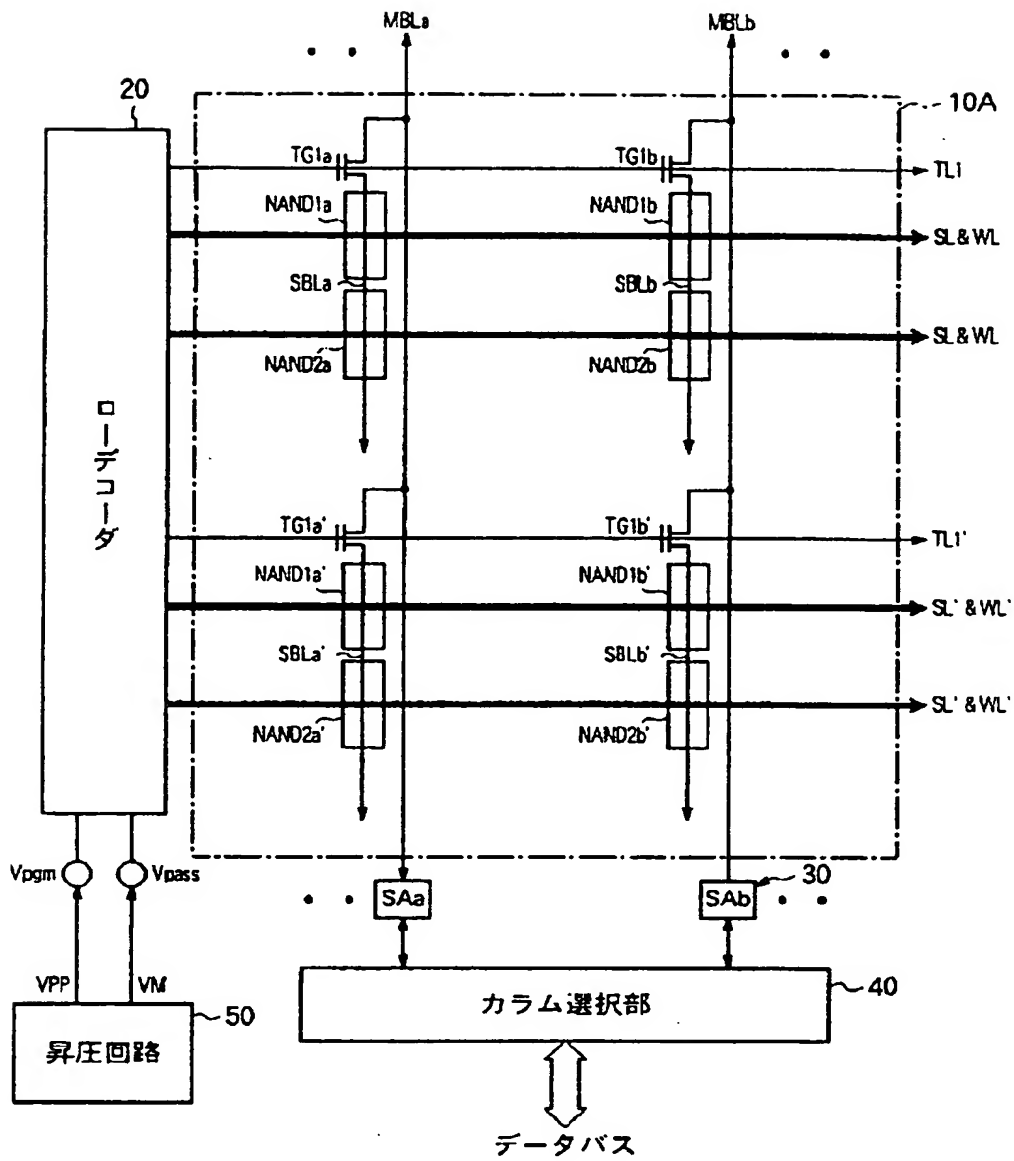
【图 28】



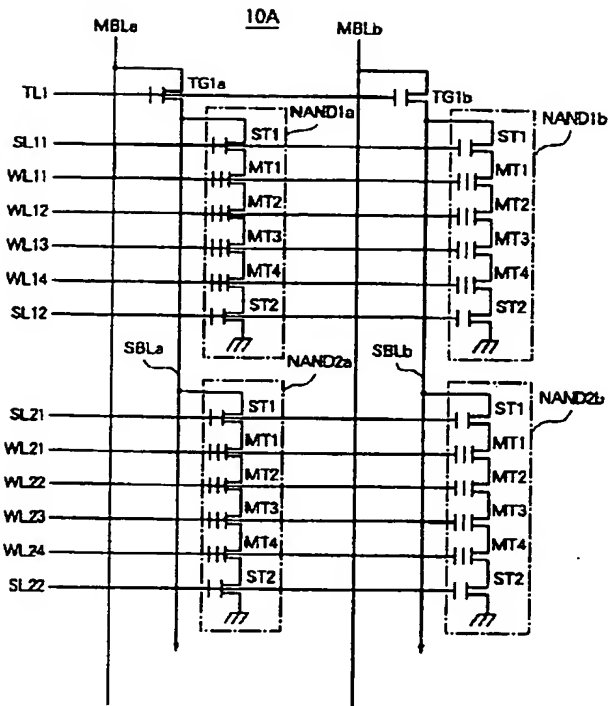
【図7】

オペレーション		プログラム (プリチャージ時)	プログラム (実プログラム時)	消去	読み出し
共通部	MBLa	VCC (3.3V) 非選択	VCC (3.3V) 非選択	フローティング	1/2VCC プリチャージ
	MBLb	GND (0V) 選択	GND (0V) 選択	フローティング	1/2VCC プリチャージ
	VSS	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)
	P WELL	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)
	TL1	GND (0V)	VCC (3.3V)	Verase (22V)	VCC (3.3V)
	TL2	Vpass (9V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)
	PCL	Vpc (9V)	Vpc (9V)	フローティング	フローティング
選択ブロック	SL11	GND (0V)	VCC (3.3V)	Verase (22V)	VCC (3.3V)
	WL11	Vpass (9V) 非選択	Vpass (9V) 非選択	GND (0V)	VCC (3.3V) 非選択
	WL12	Vpass (9V) 選択	Vpgm (18V) 選択	GND (0V)	GND (0V) 選択
	WL13	Vpass (9V) 非選択	Vpass (9V) 非選択	GND (0V)	VCC (3.3V) 非選択
	WL14	Vpass (9V) 非選択	Vpass (9V) 非選択	GND (0V)	VCC (3.3V) 非選択
	SL12	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	VCC (3.3V)
非選択ブロック	SL21	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)
	WL21	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)
	WL22	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)
	WL23	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)
	WL24	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)
	SL22	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)

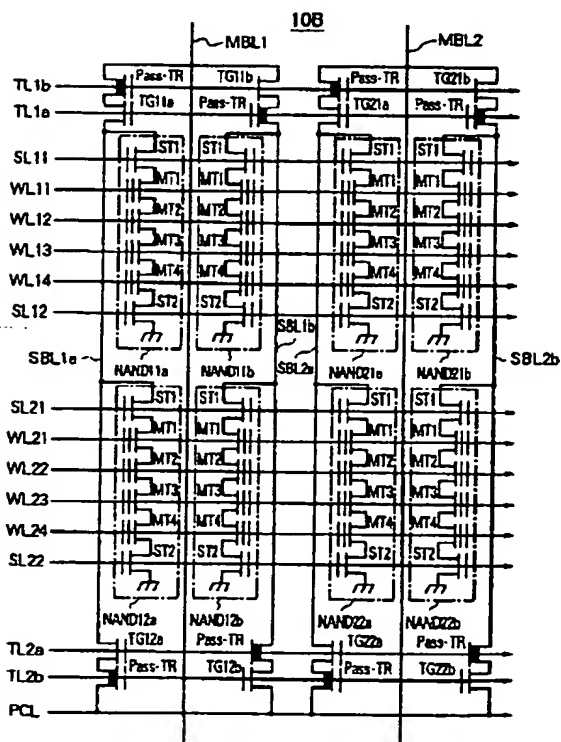
【図 8】



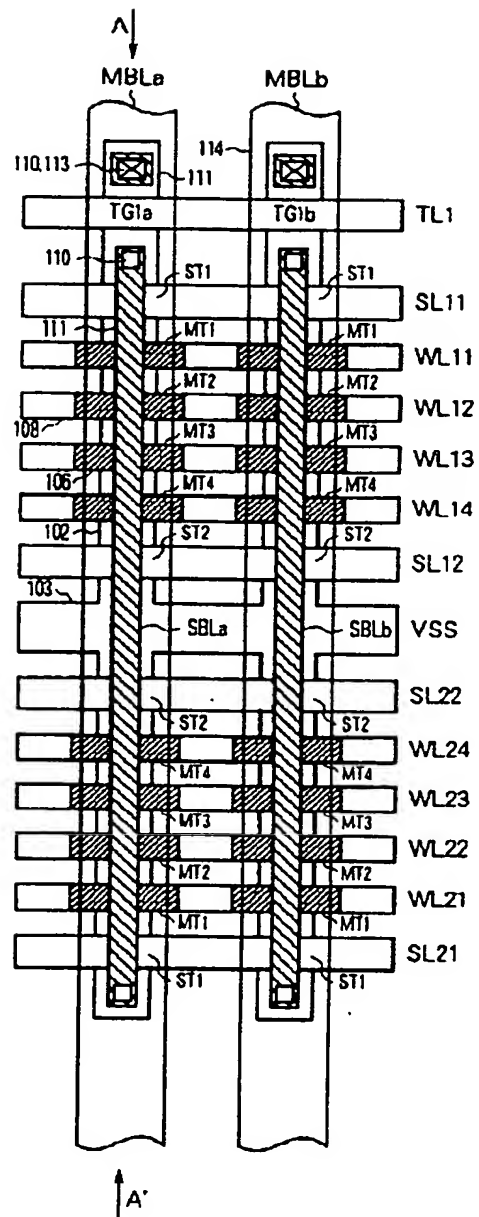
【図 9】



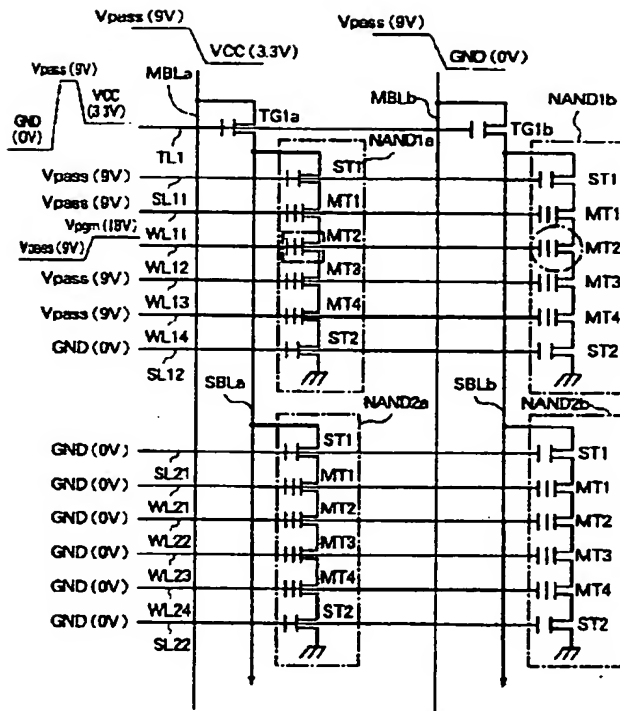
【図 1 4】



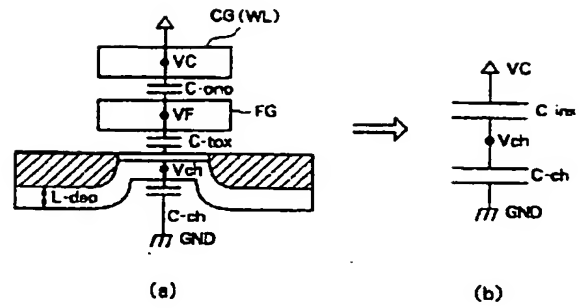
【図 1 0】



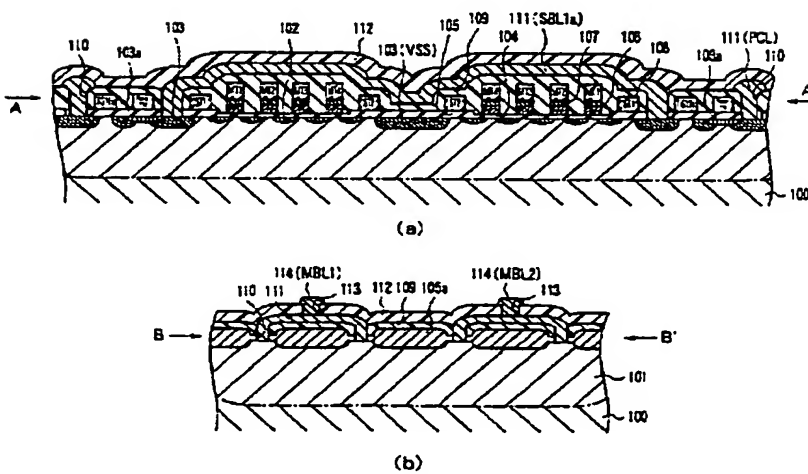
【図 12】



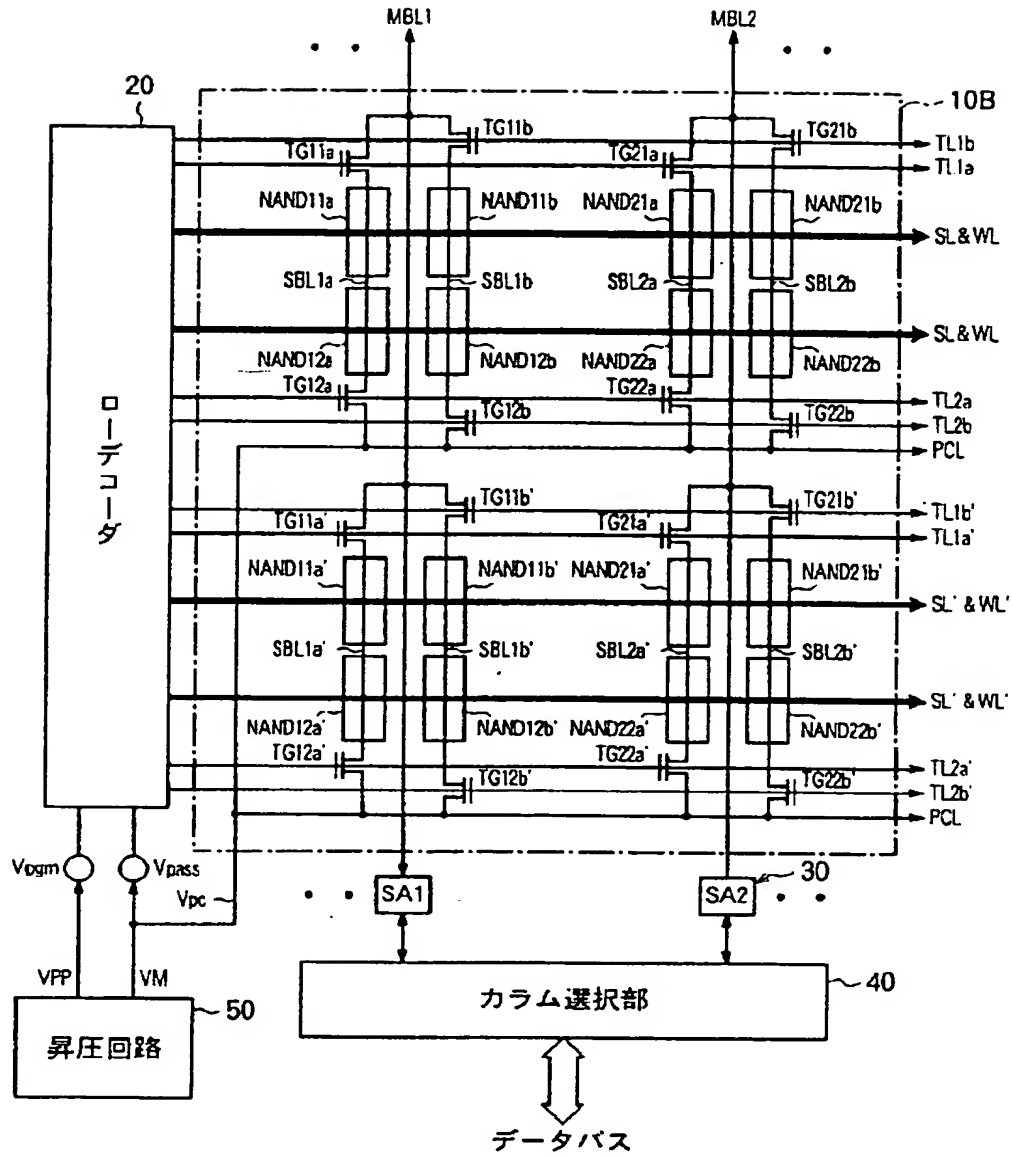
【図 29】



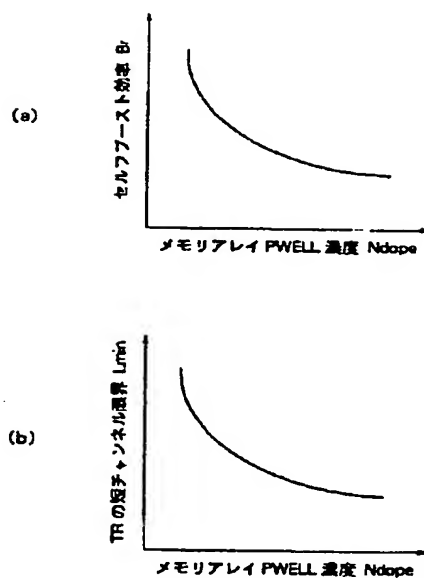
【図 16】



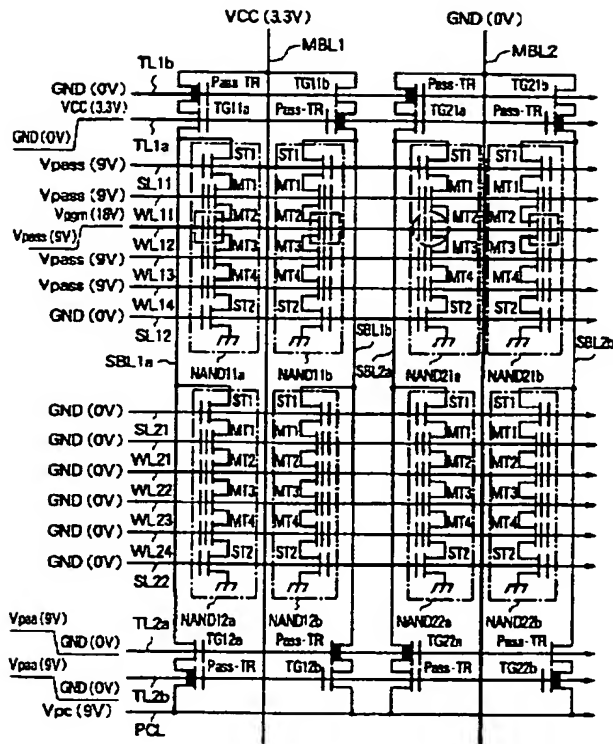
【図13】



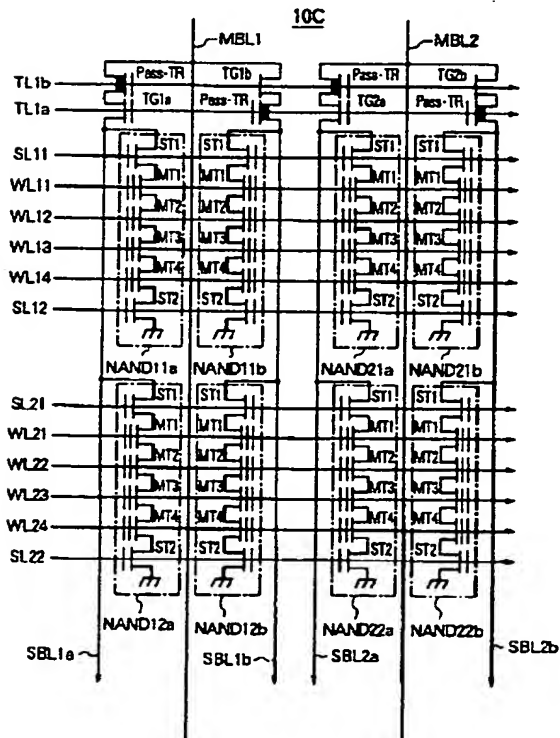
【図 30】



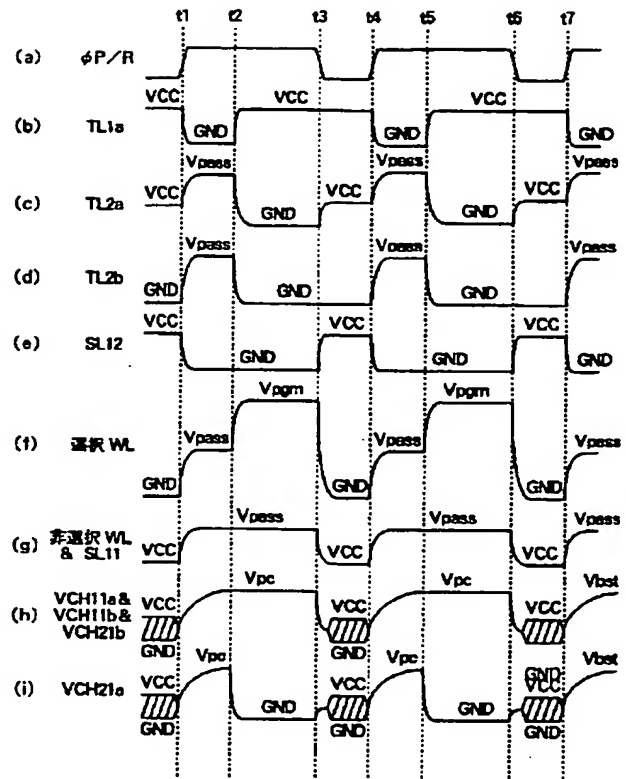
【図17】



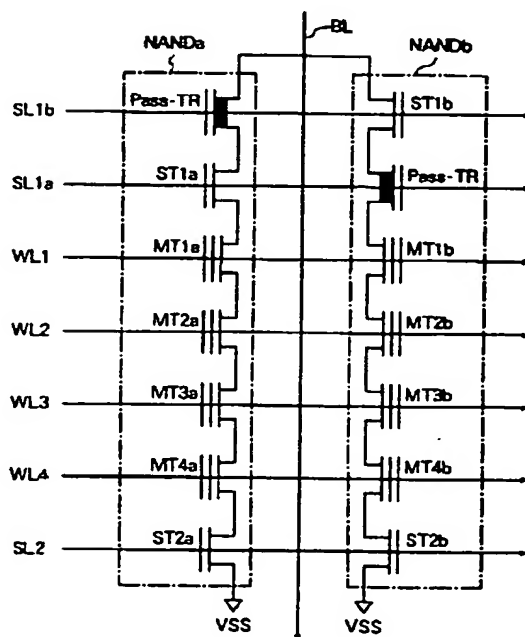
【図21】



【図18】



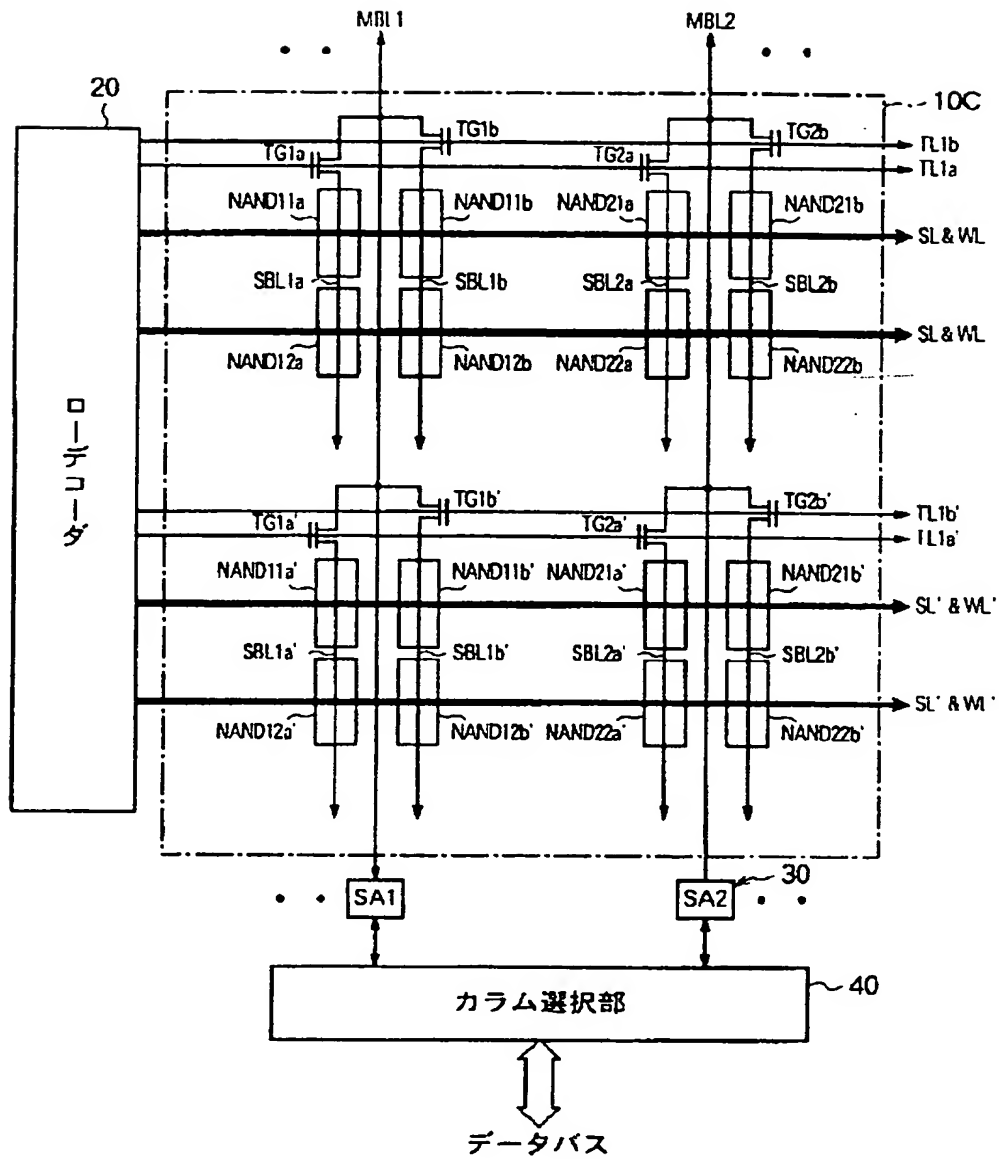
【図31】



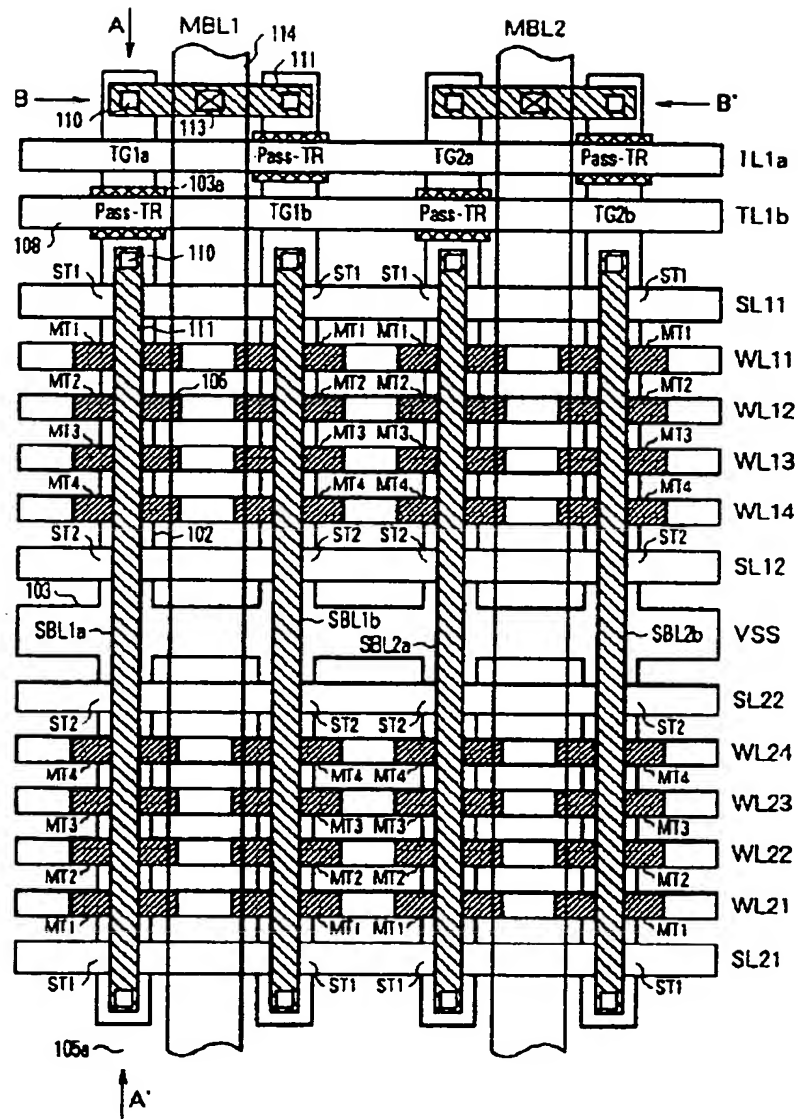
【図 19】

オペレーション		プログラム (プリチャージ時)	プログラム (実プログラム時)	消去	読み出し
共通部	MBL1	VCC (3.3V) 非選択	VCC (3.3V) 非選択	フローティング	1/2VCC プリチャージ
	MBL2	GND (0V) 選択	GND (0V) 選択	フローティング	1/2VCC プリチャージ
	VSS	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)
	P WELL	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)
	TL1a	GND (0V) 選択	VCC (3.3V) 選択	Verase (22V)	VCC (3.3V) (選択)
	TL1b	GND (0V) 非選択	GND (0V) 非選択	Verase (22V)	GND (0V) (非選択)
	TL2a	Vpass (9V) 選択	GND (0V) 選択	Verase (22V)	VCC (3.3V) 選択
	TL2b	Vpass (9V) 非選択	GND (0V) 非選択	Verase (22V)	GND (0V) 非選択
	PCL	Vpc (9V)	Vpc (9V)	フローティング	フローティング
選択ブロック	SL11	GND (0V)	VCC (3.3V)	Verase (22V)	VCC (3.3V)
	WL11	Vpass (9V) 非選択	Vpass (9V) 非選択	GND (0V)	VCC (3.3V) 非選択
	WL12	Vpass (9V) 選択	Vpgm (18V) 選択	GND (0V)	GND (0V) 選択
	WL13	Vpass (9V) 非選択	Vpass (9V) 非選択	GND (0V)	VCC (3.3V) 非選択
	WL14	Vpass (9V) 非選択	Vpass (9V) 非選択	GND (0V)	VCC (3.3V) 非選択
	SL12	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	VCC (3.3V)
非選択ブロック	SL21	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)
	WL21	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)
	WL22	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)
	WL23	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)
	WL24	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)
	SL22	GND (0V)	GND (0V)	Verase (22V)	GND (0V)

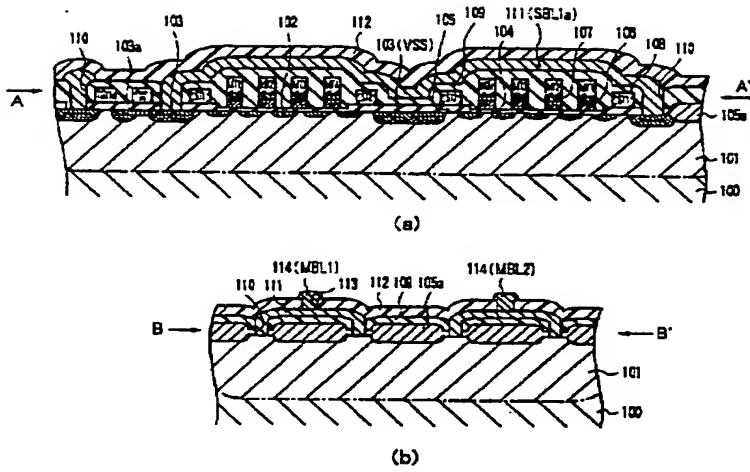
【図 20】



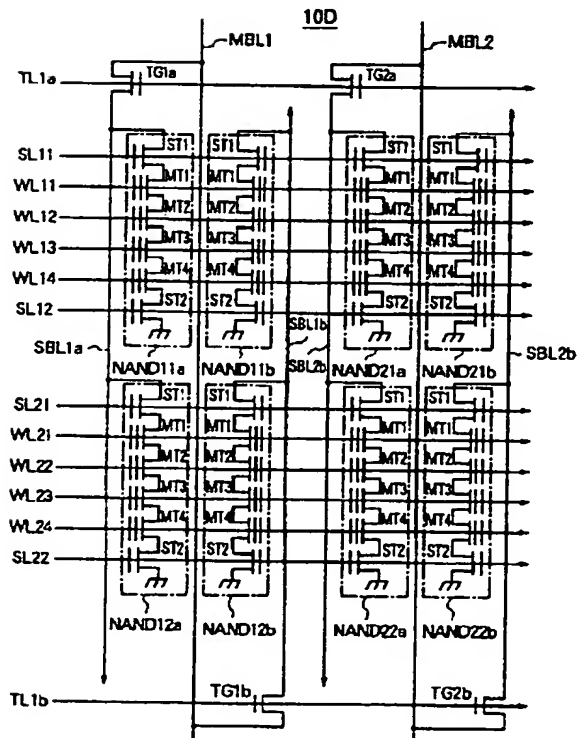
【図 22】



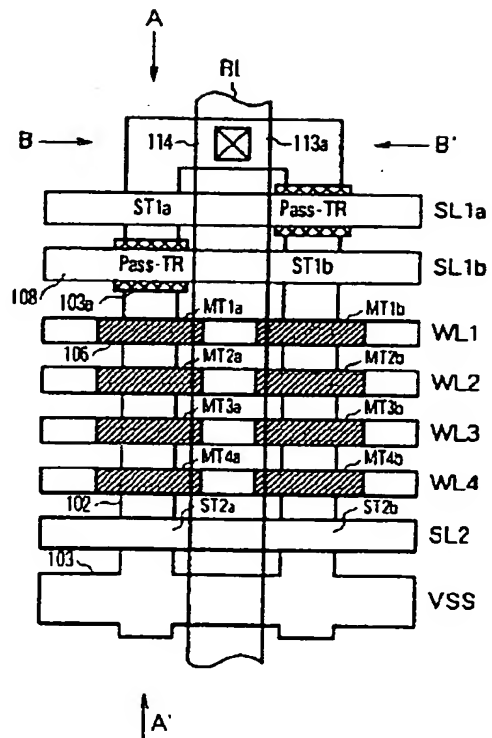
【図 23】



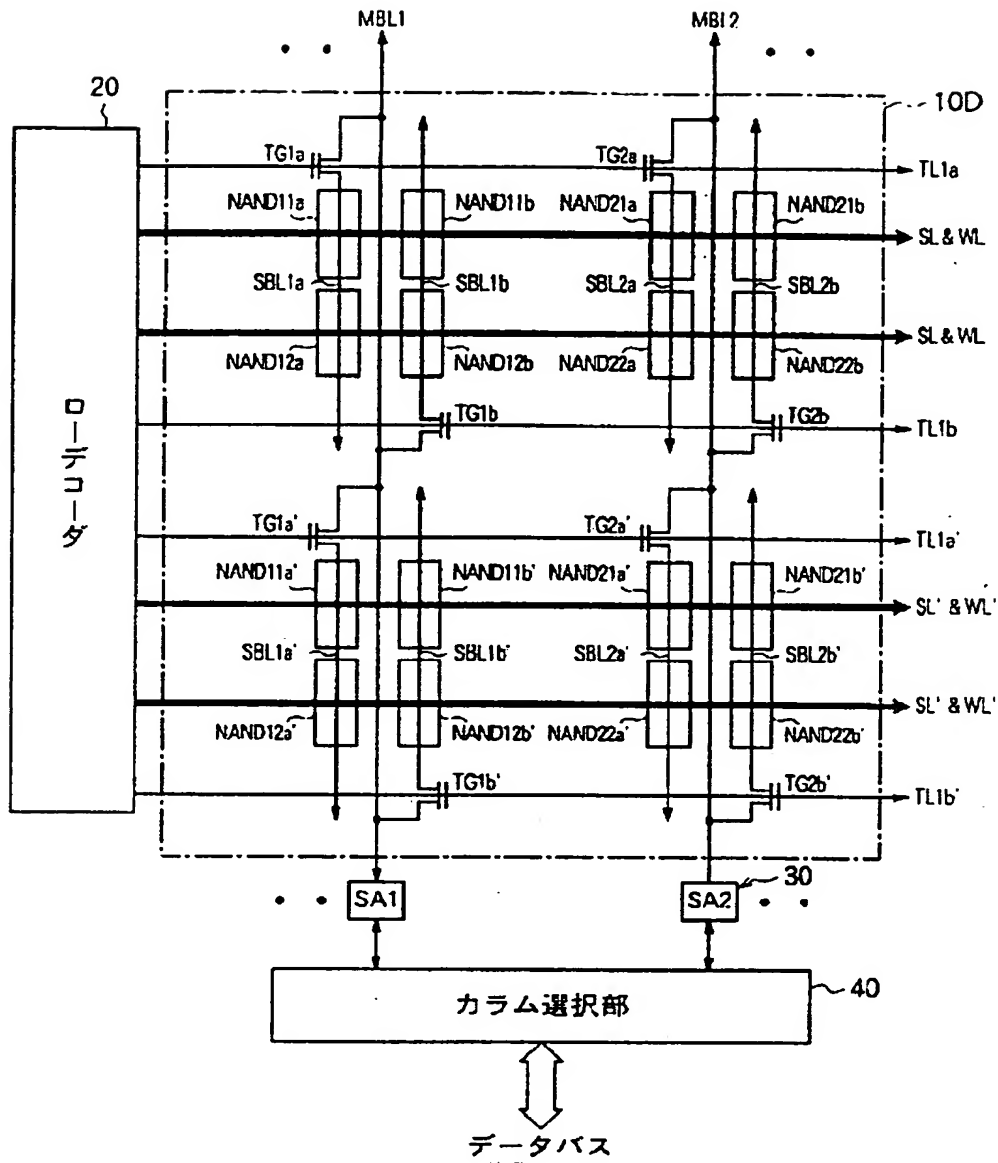
【図 25】



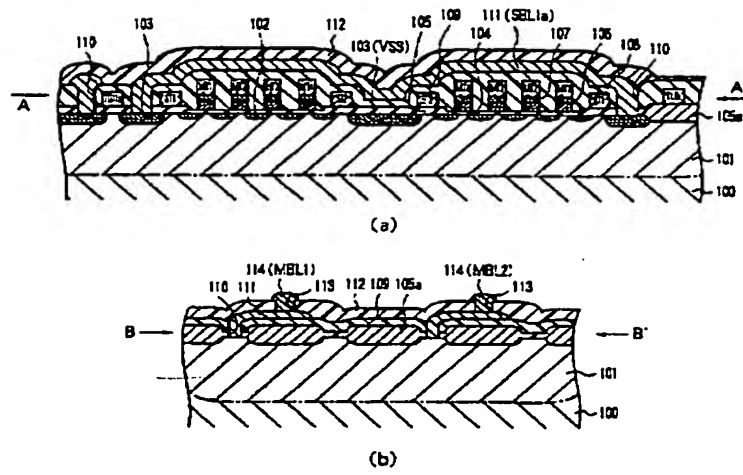
【図 32】



【図 24】



【図27】



【図33】

